

การดูดซับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟืนที่โด๊ปด้วยอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน; การศึกษาเชิงทฤษฎี Adsorption of nitrogen oxide gases on P/Ni co-doped graphene nanosheets; A theoretical study

วันดี รักไร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2562

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560)



รายงานการวิจัย เรื่อง

การดูดซับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟืนที่โด๊ปด้วยอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน; การศึกษาเชิงทฤษฎี Adsorption of nitrogen oxide gases on P/Ni co-doped graphene nanosheets; A theoretical study

วันดี รักไร่

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2562

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับทุนอุดหนุนใน การทำงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความเอื้อเฟื้อในส่วนของซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทำวิจัย ติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก ท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

> วันดี รักไร่ 2562

หัวข้อวิจัย	การดูดซับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟันที่โด๊ปด้วยอะตอมคู่
	ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน; การศึกษาเชิงทฤษฎี
ผู้ดำเนินการวิจัย	ดร.วันดี รักไร่
หน่วยงาน	สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ.	2562

บทคัดย่อ

ได้ทำการศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ และสมบัติทางพลังงานของ การดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และ ในตรัสออกไซด์ (N₂O) บนแผ่นนาโนแกรฟีน (GNS) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส (P-GNS), อะตอมไนโตรเจน (N-GNS) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN-GNS) โดยใช้ทฤษฎี ฟังก์ชันนัลความหนาแน่นที่ระดับ B3LYP/LanL2DZ ของทฤษฎี ผลการคำนวณสมบัติทางพลังงาน แสดงให้เห็นว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจน มีความสามารถดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ ได้ดีกว่าแผ่นนาโน แกรฟีนปกติ โดยมีค่าพลังงานการดูดซับที่สูงกว่าและระยะห่างของการดูดซับที่สั้นกว่า โดยพบว่าการ ดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ เป็นผลจากการโด้ปอะตอมของธาตุบนแผ่นนาโนแกรฟีน ดังนั้น แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ไนโตรเจน มีความสามารถงูดซับที่สูงกว่าและระยะห่างของการดูดซับที่สั้นกว่า โดยพบว่าการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับหรือกักเก็บแก๊สเหล่านี้ได้

Research title	Adsorption of nitrogen oxide gases on P/Ni co-doped
	graphene nanosheets; A theoretical study
Researcher	Dr. Wandee Rakrai
Organization	Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology,
	Rajabhat Maha Sarakham University
Year	2019

ABSTRACT

Structural, electronic and energy properties of nitrogen oxide gases, i.e., nitric oxide (NO), nitrogen dioxide (NO₂), and nitrous oxide (N₂O) adsorbed on pristine graphene nanosheet and P-, N-, and PN-doped graphene nanosheet have been investigated using density functional calculation at the B3LYP/LanL2DZ theoretical level. Energy properties indicated that the P-, Ni-, and PN-doped graphene nanosheets had stronger adsorption ability with nitrogen dioxide and nitrous oxide than that of pristine graphene nanosheet with their higher adsorption energy and shorter binding energy. It was found that the adsorption of nitrogen oxide gases cause the atoms doping onto graphene nanosheet. Therefore, P-, Ni-, and PN-doped graphene nanosheets can be applied as gas sensor or storage for these gases.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ঀ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	જ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 แผ่นนาโนแกรฟีน (Graphene Nanosheet, GNS)	5
2.2 เคมีคำนวณ	5
2.2.1 วิธีกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics, QM)	6
2.2.2 ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density functional theory, DFT)	8
2.2.3 เบซิสเซต ฟังก์ชัน (Basis set function)	9
2.3 โครงสร้างโมเลกุลและพลังงานโมเลกุล (Molecular structure and	
molecular energy)	11
2.4 พลังงาน HOMO LUMO ค่าผลต่างพลังงานและค่าเคมิคอลอินเดกซ์	11
2.4.1 ค่าเคมิคอลฮาร์ดเนสส์ (Chemical hardness value)	11
2.4.2 ค่าอิเล็กโทรนิกเคมิคอลโพเนนเซียล (Electronic componential	
value)	12
2.4.3 ค่ามัลลิแกนอิเล็กโทรเนคาทิวิตี (Milliken electronegativity)	12
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	18
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ	18
3.2 โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ	18
3.3 แบบจำลองโมเลกุลที่ใช้ในการศึกษา	19
3.4 ขั้นตอนการคำนวณ	20

บทที่ 4 ผลการวิจัย	22
4.1 สมบัติทางโครงสร้างของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโน	
แกรฟืน แผ่นนาโนแกรฟืนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N)	
และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN)	22
4.2 สมบัติทางพลังงานและการถ่ายโอนประจุของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน	
ออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P)	
อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN)	32
4.3 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่น	
นาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน	
(N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN)	34
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	37
บรรณานุกรม	39
ภาคผนวก	41
ประวัติผู้วิจัย	45

หน้า

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	ความยาวพันธะ (อังสตรอม, Å), มุมพันธะ (องศา, °) และค่าพลังงาน การยึดจับ (kcal/mol) ของแผ่นนาโนแกรฟีน (GNS), แผ่นนาโนแกร ฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P), อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) คำนวณที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	24
4.2	ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (อังสตรอม, Å) และมุมพันธะ (องศา, °) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน ออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน คำนวณที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	26
4.3	ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, A) ความยาวพันธะ (A) และมุม พันธะ (องศา, °) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส คำนวณที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	28
4.4	ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (Å) และมุม พันธะ (องศา, º) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปไนโตรเจน คำนวณที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	30
4.5	ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (Å) และมุม พันธะ (องศา, º) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่น นาโนแกรฟินโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน คำนวณที่ระดับของ พอนจี B2LVD/Lapt 2D7	21
16	ทฤษฎ BSLYP/LanL2DZ	51
4.0	ทาพถพรานการทูพขบ (Δε _{ads}) และการถายขยบระจุบ (งสรน (PCT) คำนาณที่ระดับของทกษภี B3I YP/I anI 2D7	34
4.7	ค่า E _{HOMO} , E _{LUMO} , ΔE _{sap} เคมิคัลฮาร์ดเนสท์ (η), อิเล็กโทรเคมิคัลโพ เทนเชียล (μ) และมัลลิเกนอิเล็กโทรเนกาติวิตี (χ) คำนวณที่ระดับ ของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	36

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	แสดงแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา (a) แผ่นนาโนแกรฟีน (b) แผ่นนาโน แกรฟีนดูดซับแก๊ส (c) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (d) แผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัสดูดซับแก๊ส (e) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ป อะตอมไนโตรเจน (f) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมไนโตรเจนดูดซับแก๊ส (g) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (h) แผ่นนาโน	
	แกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนดูดซับแก๊ส	2
2.1	แผ่นบางแกรฟีนดูดซับโมเลกุลฟอร์มาลดีไฮด์ และ (b) แผ่นบางแกรฟีนที่ โด๊ปด้วยอะลูมิเนียมดูดซับโมเลกุลฟอร์มาลดีไฮด์	13
2.2	แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน ที่โด๊ปด้วย (a) Fe, (b) Co, (c) Ni, (d) Ru, (e) Rh, (f) Pd, (g) Os, (h) Ir, และ (i) Pt. ระยะการดูดซับมีหน่วยเป็นอังสตรอม	14
2.3(a)	แสดงโครงสร้างแผ่นนาโน [้] แกรฟีนแบบปกติดูดซับแก๊ส CO, CO ₂ และ	
	H ₂ O	15
2.3(b)	แสดงโครงสร้างแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด๊ปอะตอมอะลูมิเนียมดูดซับแก๊ส CO, CO ₂ และ H ₂ O	15
2.4	แสดงโครงสร้างของ (I) โมเลกุล O3 (a), SO2 (b) และ SO3 (c) และ (II) สารประกอบเชิงซ้อนของโมเลกุลเหล่านี้กับแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอม โมรอน ตามลำดับ	16
2.5	เบรอน ศามเกทอ โครงสร้างของ (a) ท่อนาโนคาร์บอน (b) ท่อนาโนคาร์บอนโด๊ปอะตอม อะลูมิเนียม (c) ท่อนาโนคาร์บอนโด๊ปอะตอมไนโตรเจน และ (d) ท่อนา โนคาร์บอนโด๊ปอะตอมอะลมิเนียม/ไนโตรเจน	10
3.1	แสดงแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา (a) แผ่นนาโนแกรฟืน (b) แผ่นนาโน แกรฟีนดูดซับแก๊ส (c) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส (d) แผ่น นาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัสดูดซับแก๊ส (e) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ป อะตอมไนโตรเจน (f) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมไนโตรเจนดูดซับแก๊ส (g) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (h) แผ่นนาโน	
4.1	แกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนดูดซับแก๊ส แสดงโครงสร้างที่เสถียรของ (a) GNS (b) P-GNS (c) N-GNS และ (d)	19
7,1	PN-GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	23
4.2	แสดงโครงสร้างที่เสถียรของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ คำนวณด้วย	
	ทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	24

หน้า

4.3	แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกร ฟีน (a) <u>N</u> O/GNS, (b) N <u>O</u> /GNS, (c) <u>N</u> O ₂ /GNS, (d) N <u>O</u> 2/GNS, (e) _.	
	<u>N</u> 2O/GNS และ (f) N <u>2O</u> /GNS, คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่	
	ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	25
4.4	แสดงค่าประจุบนอะตอมของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ คำนวณด้วย	
	ทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	27
4.5	แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกร	
	ฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส (a) N <u>O</u> /P-GNS, (b) N <u>O</u> ₂/P-GNS และ (c) N₂ <u>O</u> /P-	
	GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	28
4.6	แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกร	
	ฟีนโด๊ปไนโตรเจน (a) <u>N</u> O/N-GNS, (b) <u>N</u> O ₂ /N-GNS และ (c) <u>N</u> ₂ O/N-	
	GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี	
	B3LYP/LanL2DZ	29
4.7	แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกร	
	ฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอส [์] ฟอรัส/ไนโตรเจน (a) N <u>O</u> /PN-GNS, (b) N <u>O</u> ₂ /PN-	
	GNS และ (c) N ₂ Q/PN-GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่	
	ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	31

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

นับตั้งแต่มีรายงานว่าสามารถแยกแผ่นนาโนแกรฟีนออกเป็นแผ่นเดี่ยวๆ ได้ในปี 2004 โดย กลุ่มวิจัยของ Novoselov (Novoselov *et.al.*, 2004) แผ่นนาโนแกรฟีนก็ได้รับความสนใจศึกษาใน สาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีเยี่ยม (Banerjee & Bhattacharyya, 2008; Basu & Bhattacharyya, 2012; Chen, Wang & Liu, 2012) โดยแผ่นนา โนแกรฟีนเป็นวัสดุชนิดหนึ่งของโครงสร้างนาโนคาร์บอนที่มีไฮบริไดเซชันเป็นแบบ *sp*² มีลักษณะเป็น แผ่น ได้มีรายงานการศึกษาการดูดซับแก๊สชนิดต่างๆ บนพื้นผิวของแผ่นนาโนแกรฟีน ที่ค่อนข้างเฉื่อย ต่อปฏิกิริยาเคมี พบว่าความแรงในการยึดจับแก๊สค่อนข้างน้อย จึงได้มีความพยายามที่จะปรับปรุง ความสามารถในการดูดซับของแผ่นนาโนแกรฟีนโดยการโด๊ปด้วยอะตอมต่างๆ ลงบนแผ่นนาโนแกร ฟีน (Kang, 2005; Ao *et.a.l.*, 2008; Ma *et.al.*, 2010; Chu *et.al.*, 2013; Chi & Zhao, 2009) ซึ่ง ที่ผ่านมาพบว่ามีนักวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำการศึกษาผลของการโด๊ปอะตอมต่างๆ ลงบนแผ่นนาโนแกร ฟีน (Chen *et.al.*, 2012; Ma *et.al.*, 2010; Kang, 2005) โดยพบว่าการโด๊ปอะตอมต่างๆ ลงบน แผ่นนาโนแกรฟีนทำให้สมบัติทางโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางแสงของแผ่นนาโนแกรฟีน เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการดูดซับโมเลกุลของสารประกอบต่างๆ มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบ กับแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติ

ในโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen Oxide) หรือน็อกซ์ คือแก๊สที่มีองค์ประกอบทางเคมีของ ในโตรเจนและออกซิเจน ในอัตราส่วนแตกต่างกัน เช่น NO, NO₂ และ N₂O เป็นต้น แก๊สในกลุ่มนี้เข้า สู่ร่างกายโดยการหายใจโดยตรง หรือในรูปไอระเหยของละอองของกรดไนตริกหรือไนตรัส หลังจากที่ แก๊สรวมตัวกับละอองน้ำหรือความชื้นแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบทางเดิน หายใจ ตา จมูก เยื่อเมือก และผิวหนังที่สัมผัส การเกิดพิษเฉียบพลัน จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ผิวหนัง เป็นสีเขียวคล้ำจากการขาดออกซิเจน หายใจลำบาก เป็นไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และอาจถึง ตายได้ (ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, 2559)

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความสามารถในการดูดซับและความสามารถในการตรวจวัด แก๊สพิษในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไน ตรัสออกไซด์ (N₂O) บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และ อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ซึ่งแบบจำลองที่ใช้ศึกษาแสดงดังภาพที่ 1.1 โดยการศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นการทำนายผลการทดลองที่ไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยากในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ผลการคำนวณทางทฤษฎียังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยลดขอบเขตการทดลองในห้องปฏิบัติการ ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีและมีความว่องไวก่อนที่จะทำการทดลองจริง ดังนั้นในปัจจุบันการศึกษา ทางทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยทางด้านเคมีคำนวณจึงได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังจะ พบได้จากการมีรายงานวิจัยทางด้านนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 1.1 แสดงแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา (a) แผ่นนาโนแกรฟีน (b) แผ่นนาโนแกรฟีนดูดซับแก๊ส (c) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (d) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัสดูดซับแก๊ส (e) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมไนโตรเจน (f) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมไนโตรเจนดูดซับแก๊ส (g) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (h) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ไนโตรเจนดูดซับแก๊ส

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ ของ แผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจน

 เพื่อศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของแผ่น นาโนแกรฟืน แผ่นนาโนแกรฟินโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เมื่อมีการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O)

 เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับและความสามารถในการตรวจวัดแก๊สกลุ่มไนโตรเจน ออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำงานวิจัยมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาโครง การวิจัย วิชานาโนเทคโนโลยี วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี วิชาเคมีทั่วไป และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

5) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการวิจัยนี้ในการประชุมหรือบทความทางวิชาการ ทั้ง ภายในและต่างประเทศ

1.3 ขอบเขตการวิจัย

 ค้นหาโครงสร้างที่เสถียรของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส ในโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน

 ค้นหาโครงสร้างที่เสถียรของของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ในโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน เมื่อมีการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไน ตริกออกไซด์ ในโตรเจนไดออกไซด์ และในตรัสออกไซด์

 คำนวณสมบัติทางพลังงาน สมบัติทางโครงสร้างในเทอมของมุมพันธะ และความยาวพันธะ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ในเทอมของการถ่ายโอนประจุบางส่วนเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติ ทางโครงสร้าง และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ในโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน

4) คำนวณสมบัติทางพลังงาน สมบัติทางโครงสร้างในเทอมของมุมพันธะและความยาวพันธะ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ในเทอมของการถ่ายโอนประจุบางส่วนเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติ ทางโครงสร้างและสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ในโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เมื่อมีการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกอ อกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์

5) การคำนวณทั้งหมดในงานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นที่ระดับ B3LYP/LandL2DZ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

 ทราบสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ ของแผ่นนา โนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

 2) ทราบสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน และสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ของแผ่นนา โนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เมื่อมีการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O)

 ทราบความสามารถในการดูดซับและความสามารถในการตรวจวัดแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกร ฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

 เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำงานวิจัยมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา โครงการวิจัย วิชานาโนเทคโนโลยี วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี วิชาเคมีทั่วไป และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

5) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการวิจัยนี้ในการประชุมหรือบทความทางวิชาการ ทั้ง ภายในและต่างประเทศ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้จะกล่าวถึง แผ่นนาโนแกรฟีน เคมีคำนวณ โครงสร้างโมเลกุลและพลังงาน โมเลกุล ความหนาแน่นสภาวะและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะขอกล่าวตามลำดับต่อไปนี้

2.1 แผ่นนาโนแกรฟีน (Graphene Nanosheet, GNS)

นาโนเทคโนโลยีเป็นสาขาใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน วัสดุระดับ นาโนของคาร์บอนเป็นวัสดุระดับนาโนชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยท่อนาโนคาร์บอนได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ใช้เป็นตัวกักเก็บแก้สไฮโดรเจน ตัวตรวจจับโมเลกุล ตัวดูดซับโมเลกุลและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าท่อนาโน คาร์บอนมีสมบัติเชิงโครงสร้าง สมบัติเชิงกายภาพและสมบัติเชิงเคมีที่โดดเด่น แผ่นนาโนแกรฟืนจัดว่า เป็นวัสดุระดับนาโนของคาร์บอนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งแกรฟืนนี้จัดเป็นวัสดุที่มี 2 มิติ มีลักษณะเป็นแผ่น บางๆ และมีพื้นที่ผิวที่สูงมาก (2630 m²/g) แต่ละขั้นของแผ่นแกรฟืนประกอบไปด้วยคาร์บอนอะตอม ต่างๆ จับตัวกันด้วยพันธะโควาเลนต์เป็นวงรูปหกเหลี่ยม คาร์บอนแต่ละตัวซึ่งมีไฮบริไดเซชันเป็นแบบ sp^2 ยึดจับกับคาร์บอนรอบๆ สามตัวด้วยพันธะโควาเลนต์และมีขอบของแผ่นที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยา เป็นอย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านอื่นได้อีกมาก นอกจากนั้นแผ่นแกรฟืนนี้ไม่เพียงแต่ จะสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติโดยการโด๊ปอะตอมต่างๆ ลงไปแทนที่คาร์บอนหรือเพิ่มหมู่ฟังก์ชัน เข้าไป แต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติโดยทำให้โครงสร้างมีตำหนิหรือสิ่งปลอมปนก็ได้เช่นกัน (Basu & Bhattacharya, 2012; Mao, *et.al*, 2013)

2.2 เคมีคำนวณ (Computational Chemistry)

เคมีคำนวณ (Lewars, 2003; Leszczynski, 2001) หมายถึง การคำนวณสมบัติต่างๆ ทาง เคมีและกายภาพของอะตอมและโมเลกุล ได้แก่ การคำนวณตามสูตร การคำนวณตามสมการเคมี เป็น ต้น นอกจากนี้เคมีคำนวณยังหมายถึงการคำนวณโครงสร้างโมเลกุล พลังงานโมเลกุล พลังงานการ เกิดปฏิกิริยา โดยในการคำนวณต้องใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ คำนวณ

ในการคำนวณหาโครงสร้างและสมบัติของโมเลกุลใดๆ สามารถหาได้จากการแก้สมการทาง คณิตศาสตร์ วิธีดังกล่าวเรียกว่า การสร้างแบบจำลองโมเลกุล (Molecular Modeling) วิธีสร้าง แบบจำลองโมเลกุลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหาโครงสร้างของสาร ซึ่งวิธีที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง โมเลกุลแบ่งออกเป็น

- กลศาสตร์โมเลกุล (Molecular Mechanics)
- กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics)
- Semi-empirical
- Ab initio
- Density functional

วิธีเอมพิริกัลไม่ได้สนใจแรงกระทำระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอน ดังนั้นการนำวิธีนี้มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างจึงอาจมีปัญหาได้ ในขณะที่เราสามารถใช้ วิธีทางกลศาสตร์ควอนตัมได้ในทุกกรณี แต่เนื่องจากการคำนวณทางควอนตัมมีความซับซ้อนและอาจ เป็นไปไม่ได้สำหรับบางโมเลกุล จึงจำเป็นต้องประมาณผลการคำนวณวิธีแอบอินิชิโอและฟังก์ชันนัล ความหนาแน่นเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงแต่ก็ต้องใช้เวลาในการคำนวณนานจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ ศึกษาโมเลกุลขนาดใหญ่ ในขณะที่วิธีเซมิ-เอมพิริกัลให้ความแม่นยำน้อยกว่าเพราะมีการประมาณ มากกว่าแต่ก็ใช้เวลาคำนวณสั้นกว่ามาก จึงสามารถใช้คำนวณโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่มากได้ แต่ก็ไม่ถึงกับ ขนาดของโมเลกุล (Macromolecule) ซึ่งถ้าจะศึกษาโมเลกุลระดับนั้นก็ต้องใช้วิธีเอมพิริกัลเท่านั้น

2.2.1 วิธีกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics, QM)

เป็นวิธีคำนวณภายใต้ทฤษฎีควอนตัม แบ่งได้ 2 วิธี คือ วิธีเซมิ-เอมไพริคัล (Semi-empirical) และวิธีแอบ อินิชิโอ (*Ab initio*)

1) วิธีเซมิ-เอมพิริคัล

เป็นวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัมที่อาศัยข้อมูลจากการทดลอง การคำนวณด้วยวิธีนี้มีหลาย วิธีซึ่งแตกต่างกันที่การประมาณค่าอินทิกรัล เช่น

- Complete neglect of differential overlap (CNDO)
- Modified intermediate neglect of differential overlap (MINDO)
- Modified neglect of diatomic differential overlap (MNDO)
- Austin model 1 (AM1)

ในทางปฏิบัติการคำนวณอินทิกรัลใช้เวลานานมาก ซึ่งในกรณีที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่มากการ คำนวณดังกล่าวก็เป็นไปไม่ได้ (ช้าเกินไปสำหรับจะนำผลมาใช้) จึงจำเป็นต้องประมาณค่าอินทิกรัล แทนการคำนวณโดยตรงจริงๆ การประมาณทำได้โดยนำผลการทดลอง เช่น ศักย์ไฟฟ้าไอออไนเซชัน (Ionization Potential; IP) พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity; EA) มาใช้แทนค่า อินทิกรัล ใช้สมมาตรของโมเลกุลและข้อสมมุติฐาน เช่น อะตอมในโมเลกุลที่ไม่ติดกันจะไม่ซ้อนเหลื่อม กัน (Zero differential overlap; ZDO) เพื่อลดการคำนวณอินทิกรัลลง ดังนั้นจำนวนอินทิกรัลที่ต้อง คำนวณจึงเหลือน้อยมากสามารถทำให้ประยุกต์กับโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ วิธีที่ใช้การประมาณพลังงาน ดังกล่าวเรียกว่า "วิธีเซมิ-เอมพิริกัล" (แต่ถ้าหากคำนวณค่าอินทิกรัลโดยตรงไม่มีการประมาณก็จะ เรียกว่า "วิธีแอบอินิซิโอ")

วิธีเซมิ-เอมพิริกัล มีการออกแบบเพื่อใช้อธิบายระบบที่แตกต่างกัน บางวิธีออกแบบสำหรับ อธิบายสเปกตรัม (โดยการ fit กับข้อมูลทางสเปกโทรสโคปี) จึงนำมาใช้อธิบายหรือพยากรณ์สเปกตรัม ได้ดี แต่อาจอธิบายเกี่ยวกับพลังงานและโครงสร้างไม่ค่อยดี และถ้าสิ่งที่สนใจห่างไกลจากข้อมูลทางการ ทดลองที่นำมาใช้ fit มาก การคำนวณด้วยวิธีเซมิ-เอมพิริกัลป์ก็จะให้ผลที่ไม่ดี ดังนั้นการเลือกใช้วิธีที่ เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการศึกษาจึงมีความสำคัญมากวิธี AM1 และ PM3 เป็นวิธีที่พัฒนาหลังสุด จึงมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าวิธีอื่นๆ 2) วิธีแอบอินิชิโอ

เป็นวิธีการคำนวณโดยอาศัยทฤษฎีที่ได้จากการแก้สมการ Schrödinger นับเป็นเป็นวิธีที่ให้ ความแม่นยำสูงแต่ก็ใช้เวลาในการคำนวณนานจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ศึกษาโมเลกุลขนาดใหญ่ ในงานวิจัยนี้จึงได้ใช้ทฤษฎีฟังก์ชัลนัลความหนาแน่น (Density functional theory, DFT) ในการ คำนวณหาโครงสร้างของสารและพลังงานของสารประกอบเพราะเป็นวิธีที่มาตรฐานใช้กันอยู่ทั่วไปและ ให้ผลการคำนวณที่ค่อนข้างดีมาก ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีเซมิเอมไพริกัลป์คือไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากการ ทดลอง

ในกลศาสตร์ควอนตัม พลังงานและสมบัติต่างๆ ของโมเลกุลสามารถหาได้จากสมการ Schrödinger ดังนี้

$$H\Psi = E\Psi \tag{2.1}$$

โดย Η คือ ตัวปฏิบัติการฮามิลโตเนียน E คือ พลังงาน Ψ คือ ฟังก์ชันคลื่นซึ่งเก็บข้อมูลทั้งหมดของโมเลกุลไว้

ดังนั้นการได้ฟังก์ชันคลื่นจึงมีความสำคัญที่สุดในกลศาสตร์ควอนตัมและฟังก์ชันคลื่นจริง (Exact wavefunction) ก็ได้จากการแก้สมการ Schrödinger เท่านั้น แต่ทว่าสมการ Schrödinger ที่ คำนึงถึงแรงกระทำระหว่างอิเล็กตรอนซึ่งรวมทั้งระบบโมเลกุลไม่สามารถหาคำตอบได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถ หาฟังก์ชันคลื่นจริงได้ อย่างไรก็ตามกลศาสตร์ควอนตัมบอกว่าเราสามารถหาสมบัติและพลังงานของ ฟังก์ชันคลื่นที่ไม่ใช่ฟังก์ชันคลื่นจริงได้จาก

$$E' = \int \Psi_{trial}^* H \Psi_{trial} dT / \int \Psi_{trial}^* \Psi_{trial} dT$$
(2.2)

โดย E คือ พลังงานประเมิน (Expectation energy) ซึ่งจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับพลังงาน จริง (Exact energy) เสมอ (E´ ≥ E) และ Ψ_{trial} คือ ฟังก์ชันคลื่นจำลอง (Trial wavefunction) ซึ่งจะ เข้าใกล้ฟังก์ชันคลื่นจริง (Exact wavefunction) เมื่อพลังงานประเมินเข้าใกล้พลังงานจริง ดังนั้น แม้ว่าเราจะไม่สามารถหาฟังก์ชันคลื่นจริงและพลังงานจริงก็จะสามารถเลือกฟังก์ชันใดๆ เป็นฟังก์ชัน คลื่นจำลองและหาพลังงานประเมินได้เสมอ ถ้าหากเราเลือกฟังก์ชันที่อยู่ในรูปพารามิเตอร์ เช่น ฟังก์ชันคลื่นจำลองจากผลรวมเชิงเส้นของอะตอมมิกออร์บิทัล (Linear combination of atomic orbital; LCAO) เราสามารถปรับค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์จนค่าพลังงาน ประเมินมีค่าต่ำที่สุด ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันคลื่นจำลองที่ได้ใกล้เคียงกับฟังก์ชันคลื่นจริงมากที่สุด สำหรับชุดพารามิเตอร์นั้น เทคนิคที่กล่าวถึงนี้เรียกว่าเทคนิค Variation ถ้าเลือกสเลเทอร์ดีเทอร์ มิแนนต์ (Slater determinant) หรือ ดีเทอร์มิแนนต์ของผลคูณของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลเป็นฟังก์ชัน คลื่นจำลองพลังงานประเมินก็สามารถเขียนได้ในรูปสมการอินทิกรัล

ซึ่งถ้าจำแนกอินทิกรัลเหล่านี้ตามจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องพบว่า 2 เทอมแรกเกี่ยวข้อง กับหนึ่งอิเล็กตรอนเป็น One-electron integral และเทอมสุดท้ายเกี่ยวข้องกับสองอิเล็กตรอนเป็น Two-electron integral พลังงานจะแสดงได้ดัง

E = [one-e integral] + [two-e integral](2.4)

$$= \Sigma H_a^{\text{core}} + \Sigma \Sigma G_{ab}$$
(2.5)

โดยที่ H_a^{core} แทน อินทิกรัลแบบหนึ่งอิเล็กตรอนในฐานออร์บิทัลเชิงโมเลกุล a G_{ab} แทน อินทิกรัลแบบสองอิเล็กตรอนในฐานออร์บิทัลเชิงโมเลกุล a และ b

เมื่อแทนออร์บิทัลเชิงโมเลกุลด้วย LCAO พลังงานก็จะแสดงผลได้ดัง

$$E = \frac{1}{2} \left\{ \Sigma D_{\mu\nu} H_{\mu\nu} \operatorname{core} + \Sigma \Sigma D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} G_{\mu\nu\lambda\sigma} \right\}$$
(2.6)

$$= \frac{1}{2} \Sigma D_{\mu\nu} [H_{\mu\nu} \operatorname{core} + \Sigma D_{\lambda\varsigma} G_{\mu\nu\lambda\varsigma}]$$
(2.7)

โดยที่ D คือ เมทริกซ์ความหนาแน่นอิเล็กตรอน (Density matrix) ในฐานอะตอมมิกออร์บิทัล H และ G คือ อินทิกรัลแบบหนึ่งและสองอิเล็กตรอนในฐานอะตอมมิกออร์บิทัล

2.2.2 ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น (Density functional theory, DFT)

ในปี ค.ศ.1964 Hohenberg และ Kohn สามารถพิสูจน์ได้ว่าพลังงานของโมเลกุลที่สภาวะ พื้น ฟังก์ชันคลื่น และสมบัติอื่นๆ ของโมเลกุลสามารถคำนวณได้จากความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่ สภาวะพื้น (Ground state electron probability density) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ 3 ตัวแปร ที่คิดค้น โดย Beck และทฤษฎีของ Lee, Yang และ Parr สำหรับพลังงานภายใต้ทฤษฎีเดนซิทีฟังก์ชัน (Density Functional Theory; DFT) เป็นดังนี้

$$E = V_{NH} + H_{CORE} + V_{ee} + Ex [\rho] + Ec[\rho]$$
(2.8)

เมื่อ V_{NH} = อันตรกิริยานิวเคลียร์ – นิวเคลียร์

H_{CORE} = การคอนทริบิวท์ทางไฟฟ้าเชิงเดี่ยว (Monoelectronic contribution) ต่อพลังงาน ทั้งหมด รวมทั้งพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนและพลังงานที่ เกิดจากอันตรกิริยาอิเล็กตรอน–นิวเคลียร์

V_{ee} = อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตระหว่างอิเล็กตรอน

Ex[**p**] = พลังงานแลกเปลี่ยน (Exchange energy)

 $Ec[\rho] = พลังงานคอร์รีเลชัน (Correlation energy)$

ρ = ฟังก์ชันความหนาแน่นของอิเล็กตรอน

2.2.3 เบซิสเซต ฟังก์ชัน (Basis set function)

โมเลคิวลาร์ออร์บิทัลซึ่งอยู่ในรูปของอะตอมมิกออร์บิทัลที่รวมกันแบบเชิงเส้น มีความถูก ต้องมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของเบซิสฟังก์ชันในการรวมกันเชิงเส้นตรงนั้น อะตอมมิก เบซิสฟังก์ชันที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมี 2 ชนิด คือ

1) อะตอมมิกออร์บิทัลแบบสเลเทอร์ (Slater-type atomic orbital; STO)

อะตอมมิกออร์บิทัลแบบสเลเทอร์แทนอะตอมมิกออร์บิทัลที่สมเหตุสมผล ซึ่งใช้ค่ามาตรฐาน ที่แนะนำโดยสเลเทอร์ แต่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในงานเชิงตัวเลข

2) อะตอมมิกฟังก์ชันชนิดเกาส์เชียน (Gaussian-Type Atomic Function; GTO)

Boys เป็นผู้แนะนำ "เกาส์เซียน ฟังก์ชัน" ในการคำนวณโมเลคิวลาร์ออร์บิทัล แต่ให้ผลดีไม่ เท่าอะตอมมิกออร์บิทัลแบบสเลเทอร์ เพราะว่าไม่มี cusp ที่นิวเคลียสดังนั้นจึงแทนอะตอมมิกออร์บิทัล ที่ค่ารัศมีน้อยๆ ได้ไม่ดี เพื่อให้ได้การแทนอะตอมมิกออร์บิทัลได้ถูกต้อง ควรใช้ผลรวมเชิงเส้นของ หลายๆ เกาส์เซียน เพราะฉะนั้นการคำนวณ LC-GTO SCF MO จึงเกี่ยวข้องกับการหาค่าอินทิกรัล มากกว่าการคำนวณของ LC-STO SCF MO เนื่องจากจำนวนของ 2 อิเล็กตรอนอินทิกรัลที่มีสาม และสี่ศูนย์กลางลดลงเหลือเป็นอินทิกรัลของสองศูนย์กลาง ในการใช้อะตอมมิกฟังก์ชันชนิดเกาส์เซียน ซึ่งใช้ในการรวมกันแบบเชิงเส้น เช่น เบซิส ฟังก์ชัน (**Φ**_µ) อาจขยายให้อยู่ในรูปเกาส์เซียนชนิด s

$$\Phi_{\mu} = \Sigma d_{\mu s} g_{s} \tag{2.9}$$

ในที่นี้สัมประสิทธิ์ d_{µs} เป็นค่าแน่นอน เบซิสฟังก์ชันแบบนี้เรียกว่าคอนแทรคเทดเกาส์เชียน (Contracted Gaussians) และแต่ละ g_s เรียกว่า พรีมิทีฟเกาส์เชียน (Primitive gaussians)

เพื่อความสะดวกในการคำนวณจึงนิยมใช้เกาส์เชียนเบซิสฟังก์ชัน (g(r)) อาจเลือกใช้แบบคอน แทรคเทดหรืออันคอนแทรคเทดเกาส์เชียน (Uncontracted gaussians) ก็ได้ การใช้เบซิสฟังก์ชันใน การคำนวณโมเลคิวลาร์ออร์บิทัลนั้นใช้ได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

 A) มินิมอลเบซิสเซต (Minimal basis sets) เป็นระดับที่ง่ายสุดของทฤษฎีแอบอินิซิโอ โมเลคิวลาร์ออร์บิทัล ใช้มินิมอลเบซิสเซตที่มีจำนวนเบซิสฟังก์ชันเท่ากับจำนวนอะตอมมิกออร์บิทัลที่ สภาวะพื้น นั่นคือรวมออร์บิทัลของทั้งเชลล์ในและเวเลนซ์เชลล์ เช่น
 H 1 อะตอม ใช้ 1s ออร์บิทัล (1 ฟังก์ชันชนิด s)

C 1 อะตอม ใช้ 1s, 2s และ 2p ออร์บิทัล (2 ฟังก์ชันชนิด s และ 1 ฟังก์ชันชนิด p) ดังนั้น จำนวนเบซิสฟังก์ชันต่ออะตอมเป็นดังนี้ H 1 อะตอม ใช้ 1 เบซิสฟังก์ชัน (1 ฟังก์ชันชนิด s)

C 1 อะตอม ใช้ 3 เบซิสฟังก์ชัน (2 ฟังก์ชันชนิด s และ 1 ฟังก์ชันชนิด p)

มินิมอลเบซิสเซต ที่ใช้กันเรียกว่า STO-KG คือ ประกอบด้วยอะตอมมิกออร์บิทัลแบบ สเลเทอร์ในเทอมของอะตอมมิกฟังก์ชันชนิดเกาส์เซียน (g(r))K ตัวอย่างของเบซิสเซตประเภทนี้ เช่น STO-3G คือ ใช้ 3 ฟังก์ชันของอะตอมมิกฟังก์ชันชนิดเกาส์เซียน ในการแทน 1 ฟังก์ชันของอะตอมมิก ออร์บิทัลแบบสเลเทอร์

B) เอ็กซ์แทนเดดเบซิลเซต (Extended basis sets) เนื่องจากมินิมอลเบซิสเซต เช่น STO-3G ยังไม่สมบูรณ์ เพราะจำนวนของอะตอมมิกเบซิสฟังก์ชันไม่เป็นสัดส่วนกับจำนวนอิเล็กตรอน ตัวอย่าง เช่น ลิเทียม 1 อะตอม มีเพียง 3 อิเล็กตรอน ใช้จำนวนฟังก์ชัน 5 ฟังก์ชัน เท่ากับฟลูออรีน 1 อะตอม ซึ่งมี 9 อิเล็กตรอน จึงพบว่าถ้าอธิบายสารประกอบที่มีธาตุ เช่น ออกซิเจนและฟลูออรีน ด้วนมินิมอล เบซิสฟังก์ชัน พบว่าไม่ดีเท่ากับโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุที่มีอิเล็กตรอนน้อยกว่า อีกประการหนึ่งคือ มินิมอลซิลเซตใช้เกาส์เซียนเอกซ์โพแนนท์ที่แน่นอนซึ่งมีสามารถขยายและหดในสภาวะแวดล้อมของ โลเมกุลที่ต่างกันเพราะว่ามินอลเบซิลเซตมีวาเวนซ์ฟังก์ชันก์ชันก์ชันเดียวสำหรับสมมาตรแต่ละชนิด ส่วน เอกซ์เทนเดดเบซิสเซตจะมีจำนวนเบซิสฟังก์ชันก์มากกว่าอะตอมมิกออร์บิทัลเพื่อทำให้ให้ออร์บิทัล ของโมเลกุลมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้เช่น H มี 1s ออร์บิทัล ใช้ 2 ฟังก์ชันชนิด s, C จะมี ออร์บิทัล 1s, 2s และ 2p ใช้ 2 ฟังก์ชันชนิด s ออร์บิทัลและ 2 ฟังก์ชันชนิด p ออร์บิทัล

- 6-21G และ 3-21G สปลิท-วาเลซ์เบชิลเซต (Spit-valence basis sets) กรณี 6-21G กำหนด สำหรับแถวที่สองของตารางธาตุ และ 3-21G กำหนดสำหรับแถวที่สามของตารางธาตุใช้ 2 เบซิสฟังก์ชัน สำหรับแต่ละวาเลนซ์อะตอมมิกออร์บิทัลใน 6-21G เบซิสเซตนั้น แต่ละอะตอมมิกออร์บิทัลใน 6-21G เบซิสเซตนั้น แต่ละอะตอมมิกออร์บิทัลซึ่งเป็นเชลล์ในแทนด้วยฟังก์ชันเดียว

- 4-31G และ 6-31G สปลิท-วาเลนซ์เบซิสเซต ซึ่งในขณะนี้เบซิสเซต ซึ่งนียมใช้แทน3-21G และ 4-31G ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับธาตุแถวแรกของตารางธาตุ รวมทั้งธาตุแถวที่สองคือ ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ และคลอรีน 4-31G ใช้ 4 เกาส์เซียนฟังก์ชัน สำหรับออร์บิทัลของเซลล์ใน (K = 4) และใช้ 3 เกาส์เซียน และ 1 เกาส์เซียนฟังก์ชัน สำหรับ 2 วาเลนซ์เซลล์ ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับ 4-31G และ 6-31G เบซิสเซต ซึ่งประกอบด้วย 6 เกาส์เซียน ในรูปรวมกันแบบเชิงเส้นสำหรับเซลล์ใน (K = 6) 3 เกาส์เซียนฟังก์ชัน สำหรับ 2 วาเลนซ์เซลล์ เพื่อความสะดวกในการคำนวณมักใช้สปลิท-วาเลนซ์เบซิสเซต ในระดับ 3-21G มากกว่า 4-21G หรือ 6-21G สำหรับ 6-21G พบว่าที่มีความสำคัญมากในการใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ สร้าง 6-31G* และ 6-31G* โพลาไรเซชันเบซิสเซต

C) โพลาไรเซซันเบซิสเซต (Polarization basis sets) จะเติมฟังก์ที่มีเลขควอนตัมโมเมนตัม เชิงมุม (Angular momentum quantum number) ที่สูงกว่าชั้นนอกสุดหนึ่งค่าเรียกว่าโพลาไรซ์ ฟังก์ชัน (Polarized function) บนเอกซ์เทนเดดเบซิส เช่น H มีการเติมฟังก์ชันชนิด p, C มีการเติม ฟังก์ชันชนิด d การเติมโพลาไรซ์ฟังก์ชันแสดงโดยเครื่องหมาย "*" หรือ "**" ตรงท้ายชื่อเบซิสเซต เช่น 6-31G และ 6-31G** โดย "*" หมายถึงโพลาไรซ์ฟังก์ชันเฉพาะอะตอมหนัก ส่วน "**" หมายถึง โพลาไรซ์ฟังก์ชันทั้งอะตอมหนักและไฮโดรเจน

โพลาไรเซชันเบซิสเซตที่ง่ายที่สุดคือ เบซิสเซตที่เสนอโดย Hariharan และ Pople สำหรับธาตุ แถวแรกและธาตุแถวที่สอง คือ 6-31G* ซึ่งทำได้โดยการเติม d-Gaussians-primitive 1 ชุด ใน สปลิท - วาเลนซ์ 6-31G เบซิสเซตของแต่ล่ะอะตอม (ที่ไม่ใช่ไฮโดรเจน) ค่าเอกซ์โพแนนท์โพลาไรเซชันของ s-ออร์บิทัลของไฮโดรเจนและฮีเลียมอะตอม 6-31G** ยกเว้นว่ามีการเติมเกาส์เซียน p- ฟังก์ชัน 1 ชุด สำหรับไฮโดรเจนและฮีเลียมอะตอม

D) เบซิสเซตร่วมกับฟังก์ชันดิฟฟิวซ์ (Basis sets incorporation diffuse function) สำหรับ แอนไอออนโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว และพันธะไฮโดรเจน จะมีความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ที่อยู่ห่างออกไปจากนิวเคลียสมาก ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการสร้างอะตอมมิกออร์บิทัล โดยรวม เอาฟังก์ชันที่มีเลขยกกำลังต่ำเข้าด้วย ตัวอย่างของเบซิสเซตประเภทนี้ได้แก่ 6-31+G(2d,2p) และ 6-311+G(2d,2p) เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มฟังก์ชันกระจายกับอะตอมที่ไม่ใช่อะตอมของไฮโดรเจนหรือ อะตอมหนักส่วนเบซิสเซต 6-31++G(2d,2p) และ 6-311++G(2d,2p) จะเพิ่มฟังก์ชันกระจายกับทุก อะตอม (รวมไฮโดรเจนด้วย)

2.3 โครงสร้างโมเลกุลและพลังงานโมเลกุล (Molecular structure and molecular energy)

โครงสร้างโมเลกุลหมายถึง โครงสร้างทางเรขาคณิตของโมเลกุล (Geometrical structure) ในการคำนวณทางโครงสร้างเรขาคณิตของโมเลกุลจะให้ผลลัพธ์เป็นรูปโครงสร้างที่ประกอบด้วย ความ ยาวพันธะ (Bond length) มุมระหว่างพันธะ (Bond angle) และมุมไดฮีดรอน (Dihedron angle)

พลังงานโมเลกุล หมายถึงพลังงานรวมของโมเลกุล (Total energy) ที่เป็นผลรวมของพลังงาน ที่เกิดจากแรงผลักระหว่างนิวเคลียส (Nucleus) แรงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนและแรงกระทำ ระหว่างอิเล็กตรอน ซึ่งพลังงานรวมของโมเลกุลสามารถคำนวณได้จากโครงสร้างโมเลกุล ในการคำนวณ พลังงานโมเลกุลจะคำนวณไปพร้อมกับโครงสร้างโมเลกุลและพลังงานรวมของโมเลกุลที่มีโครงสร้างเสถียร จะมีค่าเป็นลบเสมอ และโมเลกุลชนิดเดียวกันพลังงานรวมที่มีค่าต่ำสุดย่อมเสถียรกว่าพลังงานรวมของ โมเลกุลที่มีค่าสูงสุด ดังนั้นโครงสร้างที่คำนวณได้จะเรียกว่า "โครงสร้างโมเลกุลที่เหมาะสม" ซึ่งเป็น โครงสร้างที่เสถียรที่สุดในธรรมชาติ โดยโมเลกุลชนิดเดียวกันอาจมีโครงสร้างที่เสถียรมากกว่าหนึ่งโครงสร้าง เรียกว่าโครงรูปหรือไอโซเมอร์

2.4 พลังงาน HOMO LUMO ค่าผลต่างพลังงานและค่าเคมิคอลอินเดกซ์ (Chemical index)

ค่าเคมิคอลอินเดกซ์ ได้แก่ ค่าเคมิคอลฮาร์ดเนสส์ (Chemical hardness) ค่าอิเล็กโทรนิก เคมิคอลโพเทนเซียล (Electronic chemical potential) และค่ามัลลิแกนอิเล็กโทรเนคาทิวิตี (Mulliken electronegativity) ค่าต่าง ๆ เหล่านี้สามารถคำนวณหาได้จากพลังงาน Lowest unoccupied molecular orbital (LUMO, *E*_{LUMO}) และพลังงาน Highest occupied molecular orbital (HOMO, *E*_{HOMO}) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณโดยวิชาเคมีควอนตัม

2.4.1 ค่าเคมิคอลฮาร์ดเนสส์ (Chemical hardness value)

ค่าเคมิคอลฮาร์ดเนสส์ (η) สามารถคำนวณได้โดยอาศัยผลต่างผลต่างของพลังงาน LUMO และ HOMO (ΔΕ_{HOMO-LUMO}) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสมการ

$$\Delta E_{\text{HOMO-LUMO}} = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}}$$
(2.10)

จากนั้นนำค่า ∆E_{HOMO-LUMO} มาแทนค่าในสมการ

$$\eta = (\Delta E_{\text{HOMO-LUMO}})/2 \tag{2.11}$$

2.4.2 ค่าอิเล็กโทรนิกเคมิคอลโพเนนเชียล (Electronic componential value)

ค่าอิเล็กโทรนิกเคมิคอลโพเทนเซียล (µ) คำนวณได้โดยนำพลังงาน LUMO และพลังงาน HOMO มาแทนในสมการ

$$\mu = (E_{\rm HOMO} + E_{\rm LUMO})/2$$
 (2.12)

2.4.3 ค่ามัลลิแกนอิเล็กโทรเนคาทิวิตี (Milliken electronegativity)

ค่ามัลลิแกนอิเล็กโทรเนคาทิวิตี (χ) คำนวณได้จากสมการ

$$\chi = -(E_{HOMO} + E_{LUMO})/2$$
 (2.13)

ค่าเคมิคอลอินเดกซ์ทั้ง 3 ชนิด คำนวณจากสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และความเสถียรทางโครงสร้างของโมเลกุลได้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related works)

ได้มีรายงานการศึกษาการดูดซับของแก๊สชนิดต่างๆ บนพื้นผิวของแผ่นนาโนแกรฟันที่ค่อนข้าง เฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี พบว่าความสามารถในการดูดซับแก๊สชนิดต่างๆ เหล่านั้นมีค่าค่อนข้างน้อย (Lv & Terrones, 2012) จึงได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงความสามารถในการดูดซับของแผ่นนาโน แกรฟันโดยการโด๊ปด้วยอะตอมต่างๆ ลงบนแผ่นนาโนแกรฟัน การโด๊ปเป็นวิธีหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพมาก ในการปรับปรุงสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุได้ เช่น ด้านสมบัติเชิงโครงสร้าง สมบัติเชิงอิเล็กทรอนิคส์ และสมบัติเชิงกล เป็นต้น นอกจากนั้นแผ่นนาโนแกรฟันนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติ โดยการโด๊ปอะตอมต่างๆ ลงไปแทนที่คาร์บอนหรือเพิ่มหมู่ฟังก์ชันเข้าไปแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติ โดยทำให้โครงสร้างมีตำหนิหรือสิ่งปลอมปนก็ได้เช่นกัน (Basu & Bhattacharyya, 2012; Mao *et.al.,* 2013)

Zhao และคณะ (Chi & Zhao, 2009) ได้ศึกษาเชิงทฤษฎีการดูดซับโมเลกุลฟอร์มาลดีไฮด์ (H₂CO) บนแผ่นแกรฟีนแบบปกติและแผ่นแกรฟีนที่โด๊ปด้วยอะลูมิเนียม (ภาพที่ 2.1) ผลการศึกษา พบว่าแผ่นแกรฟีนที่โด๊ปด้วยอะลูมิเนียมมีค่าพลังงานการยึดจับที่สูง และมีระยะการดูดซับที่สั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นแกรฟีนแบบปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากโมเลกุลของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ดูดซับกับแผ่น แกรฟีนที่โด๊ปด้วยอะลูมิเนียมเป็นการดูดซับเชิงเคมี (Chemisorption)



ภาพที่ 2.1 แผ่นบางแกรฟืนดูดซับโมเลกุลฟอร์มาลดีไฮด์ และ (b) แผ่นบางแกรฟืนที่โด๊ปด้วย อะลูมิเนียมดูดซับโมเลกุลฟอร์มาลดีไฮด์

Wanno และ Tabtimsai (Wanno & Tabtimsai, 2014) ได้ทำการศึกษาเชิงทฤษฎีการดูด ซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติ และที่โด้ปด้วยอะตอมของธาตุหมู่ 8B ได้แก่ เหล็ก (Fe) รูทีเนียม (Ru) ออสเมียม (Os) โคบอลต์ (Co) โรเดียม (Rh) อิริเดียม (Ir) นิกเกิล (Ni) แพลเลเดียม (Pd) และ แพลตินัม (Pt) (ภาพที่ 2.2) พบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด้ปด้วยอะตอมของธาตุ ต่างๆ สามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีกว่าแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติ



ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟืนที่โด๊ปด้วย (a) Fe, (b) Co, (c) Ni, (d) Ru, (e) Rh, (f) Pd, (g) Os, (h) Ir, และ (i) Pt. ระยะการดูดซับมีหน่วยเป็น อังสตรอม

Rad และ Foukolaei (Rad & Foukolaei, 2015) ได้ทำการศึกษาเชิงทฤษฎีการดูดซับแก๊ส คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และน้ำ (H₂O) บนแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติ (ภาพที่ 2.3(a)) และแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด้ปอะตอมอะลูมิเนียม (Al) (ภาพที่ 2.3(b)) พบว่าการดูดซับ โมเลกุลต่างๆ โดยแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติเป็นการดูดซับทางกายภาพแบบอ่อนๆ มีระยะการดูดซับ ที่ยาว ค่าพลังงานการดูดซับต่ำ แต่การดูดซับบนแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด้ปอะตอมอะลูมิเนียมเป็นการดูด ซับทางเคมี มีระยะการดูดซับที่สั้น และมีค่าพลังงานการดูดซับที่สูง โดยค่าพลังงานการดูดซับสำหรับ โมเลกุล CO, CO₂ และ H₂O เท่ากับ -53.8 kJ/mol, -102.6 kJ/mol และ -120.5 kJ/mol ตามลำดับ



ภาพที่ 2.3(a) แสดงโครงสร้างแผ่นนาโนแกรฟีนแบบปกติดูดซับแก๊ส CO, CO₂ และ H₂O



ภาพที่ 2.3(b) แสดงโครงสร้างแผ่นนาโนแกรฟืนที่โด้ปอะตอมอะลูมิเนียมดูดซับแก๊ส CO, CO₂ และ H₂O

ในปี 2016 Rad และคณะ (Rad *et.al.*, 2016) ได้ทำการศึกษาเชิงทฤษฎีการดูดซับโอโซน (O₃) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และ ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO₃) บนแผ่นนาโนแกรฟันที่โด้ปอะตอม โบรอน (ภาพที่ 2.4) พบว่าการดูดซับโมเลกุล SO₂ และ SO₃ เป็นการดูดซับทางกายภาพมีค่าพลังงาน การดูดซับเท่ากับ -10.9 และ -15.7 kJ/mol ตามลำดับ ส่วนการดูดซับ O₃ เป็นการดูดซับทางเคมิโดย มีค่าพลังงานการดูดซับเท่ากับ -96.3 kJ/mol จากผลการทดลองสรุปได้ว่าแผ่นนาโนแกรฟันที่โด้ป อะตอมโบรอนเป็นตัวตรวจวัดที่มีความจำเพาะต่อโมเลกุล O₃



ภาพที่ 2.4 แสดงโครงสร้างของ (I) โมเลกุล O₃ (a), SO₂ (b) และ SO₃ (c) และ (II) สารประกอบ เชิงซ้อนของโมเลกุลเหล่านี้กับแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมโบรอน ตามลำดับ

นอกจากยังได้มีรายงานการวิจัยการดูดซับแก๊สบนวัสดุนาโนที่มีการโด๊ปอะตอมของธาตุเป็น คู่ (co-doped) โดย Hamadanian และ Fotooh (Hamadanian & Fotooh, 2014) ได้ทำการศึกษา เชิงทฤษฎีการดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บนท่อนาโนคาร์บอนเมื่อมีการโด๊ปด้วยอะตอม อะลูมิเนียม ไนโตรเจน และอะตอมคู่ของอะลูมิเนียม/ไนโตรเจน (ภาพที่ 2.5) จากการศึกษาพบท่อ นาโนคาร์บอนที่โด๊ปด้วยอะตอมคู่ของอะลูมิเนียม/ไนโตรเจน สามารถดูดซับแก๊ส CO ได้ดีกว่าท่อนาโน คาร์บอนที่โด๊ปเพียงอะตอมของอะลูมิเนียมหรือไนโตรเจน



ภาพที่ 2.5 โครงสร้างของ (a) ท่อนาโนคาร์บอน (b) ท่อนาโนคาร์บอนโด้ปอะตอมอะลูมิเนียม (c) ท่อ นาโนคาร์บอนโด้ปอะตอมไนโตรเจน และ (d) ท่อนาโนคาร์บอนโด้ปอะตอมอะลูมิเนียม/ไนโตรเจน

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาพบว่าการโด๊ปอะตอมของธาตุต่างๆ ลงบนแผ่นนาโนแกรฟีนและวัสดุ ระดับนาโน ทำให้สมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางพลังงาน และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ของแผ่นนา โนแกรฟีนและวัสดุระดับนาโนเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการดูดซับโมเลกุลของสารประกอบต่างๆ มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นนาโนแกรฟีนหรือวัสดุระดับนาโนแบบปกติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้สนใจ ที่จะศึกษาความสามารถในการดูดซับ และความสามารถในการตรวจวัดโมเลกุลแก๊สในกลุ่มไนโตรเจน ออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และในตรัสออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโน แกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ในบทที่ 3 จะกล่าวถึงวิธีดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการคำนวณตามเครื่องมือ โปรแกรมและ วิธีการดังนี้

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Window XP
- Server ระบบ Linux

3.2 โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ

ใช้โปรแกรม Gauss View 3.0 ในการเตรียมโครงสร้าง หลังจากเตรียมโครงสร้างเสร็จป้อน ข้อมูลส่งเข้าไปคำนวณโดยโปรแกรม Gaussian 03 และ Gaussian 09 (Frisch *et.al*, 2006; Frisch *et.al*, 2008) เปลี่ยนระบบ DOS เป็น Unix ด้วยโปรแกรม Ultra Edit 32 คำนวณผ่านระบบ Server ด้วยโปรแกรม Secure shell (SSH) หลังจากคำนวณโมเลกุลเสร็จแสดงภาพโดยใช้โปรแกรม Molekel 4.3 (Flükiger, Lüthi & Portmann, 2000)



(e)

(g)

ภาพที่ 3.1 แสดงแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา (a) แผ่นนาโนแกรฟีน (b) แผ่นนาโนแกรฟีนดูดซับแก๊ส (c) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (d) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัสดูดซับแก๊ส (e) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมไนโตรเจน (f) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมไนโตรเจนดูดซับแก๊ส (g) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (h) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจนดูดซับแก๊ส

(h)

3.4 ขั้นตอนการคำนวณ

3.4.1 เตรียมโครงสร้างของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส (P), ไนโตรเจน (N), อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) และแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ในโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O) โดยใช้โปรแกรม Gaussview 05

3.4.2 คำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส (P), ไนโตรเจน (N), อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) และแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ โดยใช้ ทฤษฎี DFT ที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ (Becke, 1988; Becke, 1993; Lee, Yang & Parr 1988; Hay & Wadt, 1985; Hay & Wadt, 1985) ด้วยโปรแกรม Gaussian 09

3.4.3 เตรียมโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส ไนโตรเจน อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน โดยใช้โปรแกรม Gaussview 05

3.4.4 คำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไน ตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัสออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน, แผ่นนาโนแกรฟีน โด๊ปฟอสฟอรัส ไนโตรเจน อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน โดยใช้ทฤษฎี DFT ที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ ด้วยโปรแกรม Gaussian 09

3.4.5 คำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic property) ได้แก่ HOMO และ LUMO ด้วยโปรแกรม Gaussian 03 และคำนวณประจุ NBO ด้วยโปรแกรม NBO 5.0 ที่ติดตั้งอยู่ในโปรแกรม Gaussian 03

3.4.6 สร้างภาพกราฟิกต่างๆ จากข้อมูลที่ได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ โปรแกรม MOLEKEL 4.3

3.4.7 คำนวณการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานการดูดซับ (△E_{ads}) ของการดูดซับแก๊สกลุ่ม ในโตรเจนออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส ในโตรเจน และอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

$$\Delta E_{ads} = E(gas/GNS) - [E(GNS) + E(gas)]$$
(3.1)

เมื่อ △E_{ads} = พลังงานการดูดซับ E(gas/GNS) = พลังงานทั้งหมดของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ที่ดูดซับบนแผ่นบาง นาโนแกรฟีน E(GNS) = พลังงานทั้งหมดของแผ่นบางนาโนแกรฟีน E(gas) = พลังงานทั้งหมดของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์

เมื่อ	$\Delta E_{\rm ads}$	= พลังงานการดูดซับ
	<i>E</i> (gas/TM-GNS	 พลังงานทั้งหมดของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ที่ดูดซับบนแผ่นนาโน
		แกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน
	<i>E</i> (TM-GNS)	= พลังงานทั้งหมดของแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และ
		อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน

E(gas) = พลังงานทั้งหมดของแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์

 $\Delta E_{\rm ads} = E(gas/TM-GNS) - [E(TM-GNS) + E(gas)]$

3.4.8 ศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ และสมบัติทางพลังงานของแผ่น นาโนแกรฟืนทุกชนิดที่ได้จากการคำนวณ

(3.2)

บทที่ 4 ผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถในการ ดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุ ชนิดใหม่ที่อาจจะสามารถนำไปเป็นวัสดุสำหรับตรวจวัดที่มีความว่องไวและจำเพาะเจาะจงต่อแก๊ส กลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้

4.1 สมบัติทางโครงสร้างของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนา โนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN)

ได้คำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของแผ่นนาโนแกรฟีน (GNS) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอม ฟอสฟอรัส อะตอมในโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน ด้วยทฤษฎีเด็นซิที่ฟังก์ชันนัลที่ระดับ ของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ โครงสร้างที่ได้จากการคำนวณแสดงในภาพที่ 4.1 และผลการคำนวณ ในเทอมของความยาวพันธะ มุมพันธะ และค่าพลังงานการยึดจับของอะตอมที่โด้ปบนแผ่นแกรฟีน แสดง ในตารางที่ 4.1 จากภาพโครงสร้างพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนเมื่อมองจากมุมมองด้านข้างจะมีลักษณะเรียบ อะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนอยู่ในระนาบเดียวกัน ความยาวพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอม C1-C2, C1-C3 และ C1-C4 มีค่าเท่ากับ 1.442, 1.427 และ 1.427 อังสตรอม ตามลำดับ มุมพันธะ ระหว่างคาร์บอนอะตอม C2-C1-C3, C3-C1-C4 และ C4-C1-C2 มีค่าเท่ากับ 119.8, 120.3 และ 119.8 องศา ตามลำดับ จากนั้นทำการโด๊ปอะตอมของฟอสฟอรัส และไนโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกร ฟื้นที่ตำแหน่ง C1 และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ลงบนแผ่นนาโนแกรฟื้นที่ตำแหน่ง C1 และ C2 พบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนสามารถยึดจับกับอะตอมของฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจนได้ โดยมีค่าพลังงานการยึดจับเท่ากับ -202.61, -361.10 และ -282.24 กิโลแคลอรีต่อโมล ตามลำดับ ซึ่งจากค่าพลังงานการยึดจับพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนสามารถยึดจับกับอะตอมของไนโตรเจนได้ ดีที่สุด รองลงมาคืออะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน และฟอสฟอรัส ตามลำดับ นอกจากนั้นการโด๊ปอะตอม ของฟอสฟอรัส และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกรฟีน ยังทำให้โครงสร้างของแผ่น นาโนแกรฟันเปลี่ยนแปลงไป โดยอะตอมของธาตุที่โด้ปจะไม่อยู่ในระนาบเดียวกับอะตอมของคาร์บอน และไฮโดรเจนของแผ่นนาโนแกรฟีน ความยาวพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมของแผ่นนาโนแกรฟีนจะ มีความยาวเพิ่มขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.818 -1.848 อังสตรอม ส่วนมุมพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอม จะมีค่าลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 95.9 - 99.4 องศา ส่วนการโด้ปอะตอมในโตรเจนลงบนแผ่นนาโน แกรฟีน มีผลทำให้โครงสร้างของแผ่นนาโนแกรฟีนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยพบว่าอะตอมของ ในโตรเจนยังอยู่ในระนาบเดียวกับอะตอมของคาร์บอน ความยาวพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมของ แผ่นนาโนแกรฟีนและมุมพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องมาจากขนาดอะตอม ของในโตรเจนมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดอะตอมคาร์บอน



ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างที่เสถียรของ (a) GNS, (b) P-GNS, (c) N-GNS และ (d) PN-GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

້	ความยาว พันธะ	ความยาว พันธะ	มุมพันธะ	มุมพันธะ	ค่าพลังงาน การยึดจับ
GNS	C1-C2	1.442	C2-C1-C3	119.8	
	C1-C3	1.427	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.427	C4-C1-C2	119.8	
P-GNS	P-C2	1.818	C2-P-C3	98.6	
	P-C3	1.821	C3-P-C4	99.4	-202.61
	P-C4	1.821	C4-P-C2	98.6	
N-GNS	N-C2	1.424	C2-N-C3	119.7	
	N-C3	1.427	C3-N-C4	120.4	-361.10
	N-C4	1.427	C4-N-C2	119.7	
PN-GNS	P-N	1.848	N-P-C3	95.9	
	P-C3	1.836	C3-P-C4	96.3	-282.24
	P-C4	1.836	C4-P-N	95.9	

ตารางที่ 4.1 ความยาวพันธะ (อังสตรอม, Å) มุมพันธะ (องศา, °) และค่าพลังงานการยึดจับ (kcal/mol) ของแผ่นนาโนแกรฟีน (GNS) แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน คำนวณที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

หมายเหตุ: ตำแหน่งอะตอมระบุตามภาพที่ 4.1

ได้คำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO), ในโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และ ไนตรัสออกไซด์ (N₂O) คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับ ของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ ผลการคำนวณแสดงในภาพที่ 4.2



Nitric oxide (NO)



Nitrogen dioxide (NO₂)



Nitrous oxide (N₂O)

ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างที่เสถียรของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิที ฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ ได้คำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน โดยหันอะตอมไนโตรเจนเข้าหาแผ่น ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (<u>N</u>O) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (<u>NO</u>) และ ในตรัสออกไซด์ (<u>N</u>2O) และหันอะตอมออกซิเจนเข้าหาแผ่น ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (<u>NO</u>) ในโตรเจน ไดออกไซด์ (<u>NO</u>2) และในตรัสออกไซด์ (N<u>2</u>O) คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ ผลการคำนวณแสดงในภาพที่ 4.3 และผลการคำนวณในเทอมของความยาวพันธะ มุมพันธะ และระยะห่างของการดูดซับ แสดงในตารางที่ 4.2 พบว่าแผ่นนาโนแกรฟันสามารถดูดซับแก๊ส กลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้ โดยสามารถวัดระยะห่างของการดูดซับได้จากความยาวพันธะระหว่างออกซิเจน อะตอมหรือไนโตรเจนอะตอมของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์กับคาร์บอนอะตอมของแผ่นนาโนแกรฟีน ที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด จากการคำนวณพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนดูดซับแก๊ส <u>NO, NO</u>2 และ <u>N</u>2O มีระยะห่าง ของการดูดซับเท่ากับ 3.729, 3.274 และ 3.100 อังสตรอม ตามลำดับ และระยะห่างของการดูดซับแก๊ส N<u>0</u>, N<u>0</u>2 และ N₂O มีค่าเท่ากับ 3.398, 3.794 และ 3.500 อังสตรอม ตามลำดับ ส่วนค่าความยาว พันธะ และมุมพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมของแผ่นนาโนแกรฟีนหลังการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน ออกไซด์มีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แสดงว่าการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์เหล่านี้เป็นการดูด ซับทางกายภาพ (physisorption)



ภาพที่ 4.3 แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน (a) <u>N</u>O/GNS, (b) N<u>O</u>/GNS, (c) <u>N</u>O₂/GNS, (d) N<u>O</u>₂/GNS, (e) <u>N</u>₂O/GNS และ (f) N₂<u>O</u>/GNS, คำนวณด้วยทฤษฎี เด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

າະປາ	ความยาว พันธะ	ความยาว พันธะ	มุมพันธะ	มุมพันธะ	ระยะห่างของ การดูดซับ
<u>N</u> O/GNS	C1-C2	1.431	C2-C1-C3	119.8	ŭ
	C1-C3	1.422	C3-C1-C4	120.2	3.729
	C1-C4	1.422	C4-C1-C2	119.8	
N <u>O</u> /GNS	C1-C2	1.443	C2-C1-C3	119.8	3.274
	C1-C3	1.427	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.427	C4-C1-C2	119.8	
<u>N</u> O ₂ /GNS	C1-C2	1.441	C2-C1-C3	119.8	3.100
	C1-C3	1.427	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.427	C4-C1-C2	119.8	
N <u>O</u> 2/GNS	C1-C2	1.443	C2-C1-C3	119.8	3.398*
	C1-C3	1.426	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.426	C4-C1-C2	119.8	
<u>N</u> 2O/GNS	C1-C2	1.442	C2-C1-C3	119.8	3.794
	C1-C3	1.426	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.426	C4-C1-C2	119.8	
N ₂ O/GNS	C1-C2	1.442	C2-C1-C3	119.8	3.500
	C1-C3	1.426	C3-C1-C4	120.3	
	C1-C4	1.426	C4-C1-C2	119.8	

ตารางที่ 4.2 ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (อังสตรอม, Å) และมุมพันธะ (องศา, °) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน คำนวณที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

หมายเหตุ: ตำแหน่งอะตอมระบุตามภาพที่ 4.1

*ระยะห่างของการดูดซับเฉลี่ย

จากการคำนวณโครงสร้างที่เสถียรของแก๊สไนตริกออกไซด์ (NO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O) พบว่าแก๊สเหล่านี้แสดงค่าประจุเป็นบวกที่ตำแหน่งไนโตรเจนอะตอม และ แสดงค่าประจุเป็นลบที่ตำแหน่งออกซิเจนอะตอม ดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 แสดงค่าประจุบนอะตอมของแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิที ฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

จากผลการคำนวณการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัสลงบนแผ่นนาโนแกรฟัน พบว่าค่าประจุของฟอสฟอรัส อะตอมมีค่าเป็นบวก ดังนั้นในการดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟันโด๊ปฟอสฟอรัส จึงหันด้านออกซิเจนอะตอมเข้าหาแผ่นเนื่องจากออกซิเจนอะตอมแสดงประจุเป็นลบ ผลการคำนวณหา โครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ NQ, NQ2 และ N2Q บนแผ่นนาโน แกรฟันโด๊ปฟอสฟอรัส (P-GNS) คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ แสดงในภาพที่ 4.5 และผลการคำนวณในเทอมของความยาวพันธะ มุมพันธะ และระยะห่างของการดูดซับ แสดงในตารางที่ 4.3 พบว่าแผ่นนาโนแกรฟันโด้ปฟอสฟอรัส สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้ โดยสามารถวัดระยะห่างของการดูดซับได้จากความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนอะตอมของแก๊สกลุ่ม ในโตรเจนออกไซด์กับฟอสฟอรัสอะตอมที่โด๊ปลงบนแผ่นนาโนแกรฟัน จากการคำนวณพบว่าแผ่นนาโนแกร ฟันดูดซับแก๊ส NQ, NQ2 และ N2Q มีระยะห่างของการดูดซับเท่ากับ 2.853, 2.006 และ 3.942 อังสตรอม ตามลำดับ ส่วนค่าความยาวพันธะ และมุมพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอมฟอสฟอรัสของ แผ่นนาโนแกรฟันโด๊ปฟอสฟอรัส หลังการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ มีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับก่อนการดูดซับ ยกเว้นการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่าหลังการดูดซับความยาว พันธะระว่างอะตอมพาร์บอนกับอะตอมฟอสฟอรัสมีค่าความยาวลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.726 - 1.738 อังสตรอม และมุมพันธะมีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 108.2 - 108.6 องศา



ภาพที่ 4.5 แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปฟอสฟอรัส (a) N<u>O</u>/P-GNS, (b) N<u>O</u>₂/P-GNS และ (c) N₂<u>O</u>/P-GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับ ของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

ตารางที่ 4.3 ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (Å) และมุมพันธะ (องศา, °) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัส คำนวณที่ระดับของ ทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

າະບປ	ความยาว พันธะ	ความยาว พันธะ	มุมพันธะ	มุมพันธะ	ระยะห่างของ การดูดซับ
N <u>O</u> /P-GNS	P-C2	1.824	C2-P-C3	97.5	2.853
	P-C3	1.824	C3-P-C4	102.2	
	P-C4	1.865	C4-P-C2	101.3	
N <u>O</u> 2/P-GNS	P-C2	1.738	C2-P-C3	108.2	2.006
	P-C3	1.726	C3-P-C4	108.6	
	P-C4	1.726	C4-P-C2	108.2	
N ₂ O/P-GNS	P-C2	1.818	C2-P-C3	98.6	3.942
	P-C3	1.821	C3-P-C4	99.3	
	P-C4	1.821	C4-P-C2	98.6	

หมายเหตุ: ตำแหน่งอะตอมระบุตามภาพที่ 4.1

จากผลการคำนวณการโด๊ปอะตอมไนโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกรฟืนพบว่าค่าประจุของไนโตรเจน อะตอมมีค่าเป็นลบ ดังนั้นในการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปไนโตรเจน จึง หันด้านในโตรเจนอะตอมเข้าหาแผ่นเนื่องจากไนโตรเจนอะตอมแสดงประจุเป็นบวก ผลการคำนวณหา โครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ <u>NO</u>, <u>NO</u>² และ <u>N</u>²O บนแผ่นนาโน แกรฟินโต๊ปไนโตรเจน (N-GNS) คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ แสดงในภาพที่ 4.6 และผลการคำนวณในเทอมของความยาวพันธะ มุมพันธะ และระยะห่างของการ ดูดซับ แสดงในตารางที่ 4.4 พบว่าแผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปไนโตรเจน สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน ออกไซด์ได้ โดยสามารถวัดระยะห่างของการดูดซับได้จากความยาวพันธะระหว่างไนโตรเจนอะตอมของ แก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์กับไนโตรเจนอะตอมที่โด๊ปลงบนแผ่นนาโนแกรฟิน จากการคำนวณพบว่า แผ่นนาโนแกรฟินดูดซับแก๊ส <u>NO</u>, <u>NO</u>² และ <u>N</u>²O มีระยะห่างของการดูดซับเท่ากับ 2.406, 2.788 และ 3.115 อังสตรอม ตามลำดับ ส่วนค่าความยาวพันธะ และมุมพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอม ในโตรเจนของแผ่นนาโนแกรฟินโต๊ปไนโตรเจน หลังการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนองปนต่นแลง เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนการดูดซับ โดยมีค่าความยาวพันธะอยู่ระหว่าง 1.408 - 1.428 อังสตรอม และมุมพันธะมีค่าอยู่ระหว่าง 119.7 - 120.4 องศา



ภาพที่ 4.6 แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปไนโตรเจน (a) <u>N</u>O/N-GNS, (b) <u>N</u>O₂/N-GNS และ (c) <u>N</u>₂O/N-GNS คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับ ของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

ระบบ	ความยาว พันธะ	ความยาว พันธะ	มุมพันธะ	มุมพันธะ	ระยะห่างของ การดูดซับ
<u>N</u> O/N-GNS	N-C2	1.428	C2-N-C3	120.0	
	N-C3	1.424	C3-N-C4	119.8	2.406
	N-C4	1.418	C4-N-C2	120.1	
<u>N</u> O ₂ /N-GNS	N-C2	1.428	C2-N-C3	119.7	
	N-C3	1.410	C3-N-C4	120.3	2.788
	N-C4	1.408	C4-N-C2	119.8	
<u>N</u> 2O/N-GNS	N-C2	1.422	C2-N-C3	119.7	
	N-C3	1.425	C3-N-C4	120.4	3.115
	N-C4	1.425	C4-N-C2	119.7	

ตารางที่ 4.4 ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (Å) และมุมพันธะ (องศา, °) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปไนโตรเจน คำนวณที่ระดับของ ทฤษฏี B3LYP/LanL2DZ

หมายเหตุ: ตำแหน่งอะตอมระบุตามภาพที่ 4.1

จากผลการคำนวณการโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกรฟีน พบว่าค่า ้ประจุของฟอสฟอรัสอะตอมมีค่าเป็นบวก ส่วนค่าประจุของในโตรเจนอะตอมมีค่าเป็นลบ ดังนั้นในการ ดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟืนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน จึงหันด้าน ้ออกซิเจนอะตอมเข้าหาแผ่นเนื่องจากออกซิเจนอะตอมแสดงประจุเป็นลบ และตำแหน่งที่เหมาะสมใน การดูดซับแก๊สคือบริเวณตำแหน่งฟอสฟอรัสอะตอมและในโตรเจนอะตอมที่โด๊ปลงบนแผ่นนาโนแกรฟีน ผลการคำนวณหาโครงสร้างที่เสถียรของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ NO, NO2 และ N2O บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN-GNS) คำนวณด้วยทฤษฎีเด็นซิที่ฟังก์ชันนัล ที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ แสดงในภาพที่ 4.7 และผลการคำนวณในเทอมของความยาวพันธะ ้มุมพันธะ และระยะห่างของการดูดซับ แสดงในตารางที่ 4.5 พบว่าแผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ในโตรเจน สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์ได้ โดยสามารถวัดระยะห่างของการดูด ซับได้จากความยาวพันธะระหว่างออกซิเจนอะตอมของแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์กับฟอสฟอรัสอะตอม หรือไนโตรเจนอะตอมที่โด๊ปลงบนแผ่นนาโนแกรฟีน จากการคำนวณพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนดูดซับแก๊ส NO, NO2 และ N2O มีระยะห่างของการดูดซับเท่ากับ 3.269, 2.784 และ 3.306 อังสตรอม ตามลำดับ ้ค่าความยาวพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอมฟอสฟอรัส และระหว่างอะตอมฟอสฟอรัสกับอะตอม ในโตรเจนของแผ่นนาโนแกรฟีนด์ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนหลังการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน ้ออกไซด์มีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนการดูดซับ ค่ามุมพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอน กับอะตอมฟอสฟอรัส และอะตอมของไนโตรเจนของแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน หลังการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์มีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับก่อน

การดูดซับ ยกเว้นการดูดซับแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ พบว่าหลังการดูดซับความยาวพันธะระหว่างอะตอม คาร์บอนกับอะตอมฟอสฟอรัส และระหว่างอะตอมฟอสฟอรัสกับอะตอมไนโตรเจน มีค่าความยาวลดลง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.787 - 1.801 อังสตรอม และมุมพันธะมีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 97.5 -100.2 องศา



ภาพที่ 4.7 แสดงโครงสร้างการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (a) N<u>O</u>/PN-GNS, (b) N<u>O</u>₂/PN-GNS และ (c) N₂<u>O</u>/PN-GNS คำนวณด้วย ทฤษฎีเด็นซิทีฟังก์ชันนัลที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

ตารางที่ 4.5 ระยะห่างของการดูดซับ (อังสตรอม, Å) ความยาวพันธะ (Å) และมุมพันธะ (องศา, °)
ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจา	J
คำนวณที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ	

າະບາ	ความยาว พันธะ	ความยาว พันธะ	มุมพันธะ	มุมพันธะ	ระยะห่างของ การดูดซับ
N <u>O</u> /PN-GNS	P-N	1.787	N-P-C3	100.2	
	P-C3	1.800	C3-P-C4	97.5	3.269*
	P-C4	1.801	C4-P-N	100.0	
N <u>O</u> 2/PN-GNS	P-N	1.822	N-P-C3	96.3	
	P-C3	1.826	C3-P-C4	96.2	2.784*
	P-C4	1.839	C4-P-N	95.4	
N ₂ O/PN-GNS	P-N	1.848	N-P-C3	95.8	
	P-C3	1.836	C3-P-C4	96.2	3.306
	P-C4	1.836	C4-P-N	95.8	

หมายเหตุ: ตำแหน่งอะตอมระบุตามภาพที่ 4.1

*ระยะห่างของการดูดซับเฉลี่ย

จากการทดลองจะพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริกออกไซด์ (NO) ในโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O) ได้ดีกว่าแผ่นนาโนแกรฟีนที่ไม่ได้โด้ป โดยมีระยะการดูดซับโดยเฉลี่ยที่สั้นกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tabtimsai และคณะ (Tabtimsai & Wanno, 2014) ที่พบว่าการโด้ปอะตอมของโลหะทรานซิชันได้แก่ เหล็ก (Fe) รูทีเนียม (Ru) ออสเมียม (Os) โคบอลต์ (Co) โรเดียม (Rh) อิริเดียม (Ir) นิกเกิล (Ni) แพลเลเดียม (Pd) และแพลทินัม (Pt) สามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ได้ดีกว่าแผ่นนาโนแกรฟีนที่ไม่ได้โด้ป โดยมีระยะการดูด ซับอยู่ระหว่าง 1.848 – 2.065 อังสตรอม สำหรับแผ่นนาโนแกรฟีนที่ได้ปอะตอมโลหะทรานซิชัน ส่วน ระยะการดูดซับของแผ่นนาโนแกรฟีนที่ไม่ได้โด๊ปมีค่าเท่ากับ 3.576 อังสตรอม

4.2 สมบัติทางพลังงานและการถ่ายโอนประจุของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่น นาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN)

พลังงานการดูดซับ (Adsorption energies, ∆E_{ads}) และการถ่ายโอนประจุบางส่วน (Partial charge transfer, PCT) ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโน แกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) แสดงในตารางที่ 4.6

จากการคำนวณพบว่าค่าพลังงานการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -0.21 ถึง -18.36 กิโลแคลอรี/โมล เรียงลำดับความสามารถของการดูดซับที่ ิลดลงได้ดังนี้ <u>N</u>O₂/GNS (-18.36 กิโลแคลอรี/โมล) > N<u>O</u>₂/GNS (-18.09 กิโลแคลอรี/โมล) > NQ/GNS (-17.14 กิโลแคลอรี/โมล) > NO/GNS (-11.09 กิโลแคลอรี/โมล) > N₂O/GNS (-0.30 กิโล แคลอรี/โมล) > N₂O/GNS (-0.21 กิโลแคลอรี/โมล) ตามลำดับ ค่าพลังงานการดูดซับแก๊สกลุ่ม ้ในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปฟอสฟอรัส มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -10.74 ถึง -41.10 กิโล แคลอรี/โมล เรียงลำดับความสามารถของการดูดซับที่ลดลงได้ดังนี้ N₂O/P-GNS (-41.10 กิโลแคลอรี/ โมล) > NQ₂/P-GNS (-34.86 กิโลแคลอรี/โมล) > NQ/P-GNS (-10.74 กิโลแคลอรี/โมล) ตามลำดับ ค่าพลังงานการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วง ระหว่าง -1.57 ถึง -19.25 กิโลแคลอรี/โมล เรียงลำดับความสามารถของการดูดซับที่ลดลงได้ดังนี้ <u>NO₂/N-GNS (-19.25 กิโลแคลอรี/โมล)> NO/N-GNS (-12.10 กิโลแคลอรี/โมล) > > N₂O/N-GNS (-</u> 1.57 กิโลแคลอรี/โมล) ตามลำดับ และค่าพลังงานการดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโน แกรฟินโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง -14.05 ถึง -88.52 กิโล แคลอรี/โมล เรียงลำดับความสามารถของการดูดซับที่ลดลงได้ดังนี้ N<u>O</u>2/PN-GNS (-88.52 กิโล แคลอรี/โมล) > N₂O/PN-GNS (-55.93 กิโลแคลอรี/โมล) > NO/PN-GNS (-14.05 กิโลแคลอรี/โมล) ตามลำดับ

จากผลการทดลองจะพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) สามารถดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัส ออกไซด์ (N₂O) ได้ดีกว่าแผ่นนาโนแกรฟีนที่ไม่ได้โด๊ป โดยมีค่าพลังงานการดูดซับที่สูงกว่าและมีระยะห่าง ของการดูดซับที่สั้นกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้ดีกว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปฟอสฟอรัสและไนโตรเจน โดยมีค่าพลังงานการดูดซับที่สูงกว่า

จากการคำนวณหาค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วน (PCT) พบว่าระบบ NQ/GNS, N₂Q/GNS, N₂Q/GNS, N₂Q/P-GNS, N₂Q/N-GNS และ N₂Q/PN-GNS มีการถ่ายโอนประจุบางส่วนจากแก๊ส มายังแผ่นนาโนแกรฟืน แผ่นนาโนแกรฟืนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เนื่องจากค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนมีค่าเป็นบวก สำหรับระบบ NO₂/GNS, NQ₂/GNS, NQ₂/GNS, NQ₂/P-GNS และ NQ₂/PN-GNS มีการถ่ายโอนประจุบางส่วนจากแผ่นนาโน แกรฟืน แผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส ไนโตรเจนมายังแก๊ส เนื่องจาก มีค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนมายังแก๊ส เนื่องจาก มีค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนจากแผ่นนาโน แกรฟืน แผ่นนาโนแกรฟินโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนมายังแก๊ส เนื่องจาก มีค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนเป็นลบ นอกจากนั้นยังพบว่าค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนระหว่างแก๊ส กลุ่มไนโตรเจนออกไซด์กับแผ่นนาโนแกรฟินมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.001 – 0.131 อิเล็กตรอน และค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนระหว่างแก๊สกลุ่มไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.001 – 0.131 อิเล็กตรอน และค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนระหว่างแก๊สกลุ่มไนโตรเจน มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.002 – 0.544 อิเล็กตรอน โดยพบว่า NO₂/PN-GNS มีค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนระหว่างแก๊สกลุ่มไนโตรเจน โดยพบว่า NO₂/PN-GNS มีค่าการถ่ายโอนประจุบางส่วนมากสุดเท่ากับ 0.544 อิเล็กตรอน ซึ่งสอดคล้องกับค่าพลังงานการดูดซับที่มีค่ามากที่สุด

ระบบ	ค่าพลังงานการดูดซับ	การถ่ายโอนประจุบางส่วน (PCT) ^b
<u>N</u> O/GNS	-11.90	0.000
N <u>O</u> /GNS	-17.14	0.001
<u>N</u> O ₂ /GNS	-18.36	-0.131
N <u>O</u> 2/GNS	-18.09	-0.122
<u>N</u> 20/GNS	-0.30	0.002
N ₂ 0 /GNS	-0.21	0.001
N <u>O</u> /P-GNS	-10.74	-0.084
N <u>O</u> 2/P-GNS	-34.86	-0.529
N ₂ 0 /P-GNS	-41.10	0.002
<u>N</u> O/N-GNS	-12.10	с -
<u>N</u> O ₂ /N-GNS	-19.25	
<u>N</u> 20/N-GNS	-1.57	0.002
N <u>O</u> /PN-GNS	-14.05	с -
N <u>O</u> 2/PN-GNS	-88.52	-0.544
N ₂ O/PN-GNS	-55.93	0.002

ตารางที่ 4.6 ค่าพลังงานการดูดซับ (∆E_{ads}) และการถ่ายโอนประจุบางส่วน (PCT) คำนวณที่ระดับของ ทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

[°] มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี/โมล

^b มีหน่วยเป็นอิเล็กตรอน

^c non convergence

4.3 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ไนโตรเจน (PN)

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ในเทอมของพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ (Highest occupied molecular orbital, $E_{\rm HOMO}$) พลังงานต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ (Lowest unoccupied molecular orbital, $E_{\rm LUMO}$) แถบพลังงาน ($\Delta E_{\rm gap}$) ค่าเคมิคัลฮาร์ดเนสท์ (η) ค่าอิเล็กโทรเคมิคัลโพเทนเชียล (μ) และค่ามัลลิเกนอิเล็กโทรเนกาติวิตี (χ) ของการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และ อะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) ลงบนแผ่นนาโนแกรฟีน การดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจนและอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) ถงบนแผ่นนาโนแกรฟีน แสดงดังตารางที่ 4.7 พบว่าค่า $\Delta E_{\rm gap}$ ของแผ่นนาโนแกรฟีนก่อนโด๊ปมีค่าเท่ากับ 0.245

อิเล็กตรอนโวลต์ หลังจากมีการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส และอะตอมไนโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกรฟัน พบว่าค่า ∆E_{sap} ของแผ่นนาโนแกรฟันมีค่าเพิ่มขึ้นโดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.061 - 1.742 อิเล็กตรอน โวลต์ ส่วนการโด๊ปอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนลงบนแผ่นนาโนแกรฟัน พบว่าค่า ∆E_{sap} ของแผ่นนา โนแกรฟันไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีค่าเท่ากับ 0.245 อิเล็กตรอนโวลต์ นอกจากนั้นยังพบว่าค่าเคมิคัล ฮาร์ดเนสท์ ค่าอิเล็กโทรเคมิคัลโพเทนเชียล และค่ามัลลิเกนอิเล็กโทรเนกาติวิตี ของแผ่นนาโนแกรฟัน หลังการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัสและอะตอมไนโตรเจน มีค่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับก่อนโด๊ป สรุปได้ ว่าการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน มีผลต่อสมบัติทาง อิเล็กทรอนิกส์ของแผ่นนาโนแกรฟัน แกรฟันไล่ยนไป ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นตัวตรวจวัด แก๊สได้

ค่า $\Delta E_{\rm gap}$ ของการดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.245 - 1.442 อิเล็กตรอนโวลต์ และค่า $\Delta E_{\rm gap}$ ของการดูดซับแก๊สกลุ่มในโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนา โนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน มีค่าอยู่ ระหว่าง 0.272 - 1.742 อิเล็กตรอนโวลต์ พบว่าค่า $\Delta E_{\rm gap}$ ของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีน โด้ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน หลังดูดซับแก๊สกลุ่ม ในโตรเจนออกไซด์มีค่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับก่อนดูดซับ นอกจากนั้นยังพบว่าค่าเคมิคัลฮาร์ดเนสท์ ค่าอิเล็กโทรเคมิคัลโพเทนเซียล และค่ามัลลิเกนอิเล็กโทรเนกาติวิตีของแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโน แกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน หลังการดูดซับ แก๊สกลุ่มไนโตรเจนไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับก่อนดูดซับ ดังนั้นสรุปได้ ว่าการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับก่อนดูดซับ ดังนั้นสรุปได้ ว่าการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับก่อนดูดซับ ดังนั้นสรุปได้ ว่าการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ทำให้สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของแผนนาโน แกรฟีน และแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด๊ปเปลี่ยนแปลงไป จึงสามารถนำเอาวัสดุนี้ไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สได้

າະບບ	E _{HOMO} (eV)	$E_{\rm LUMO}$ (eV)	ΔE_{gap} (eV)	η (eV)	μ (eV)	χ (eV)
GNS	-3.918	-3.674	0.245	0.122	-3.796	3.796
P-GNS (Alpha)	-4.572	-2.912	1.660	0.830	-3.742	3.742
P-GNS (Beta)	-4.708	-2.966	1.742	0.871	-3.837	3.837
N-GNS (Alpha)	-3.946	-2.884	1.061	0.531	-3.415	3.415
N-GNS (Beta)	-4.544	-2.966	1.578	0.789	-3.755	3.755
PN-GNS	-3.918	-3.674	0.245	0.122	-3.796	3.796
<u>N</u> O/GNS (Alpha)	-4.599	-3.184	1.415	0.707	-3.891	3.891
<u>N</u> O/GNS (Beta)	-4.245	-3.048	1.197	0.599	-3.646	3.646
N <u>O</u> /GNS (Alpha)	-4.626	-3.184	1.442	0.721	-3.905	3.905
N <u>O</u> /GNS (Beta)	-4.299	-3.429	0.871	0.435	-3.864	3.864
<u>N</u> O ₂ /GNS (Alpha)	-4.653	-3.973	0.680	0.340	-4.313	4.313
<u>N</u> O ₂ /GNS (Beta)	-4.354	-3.048	1.306	0.653	-3.701	3.701
N <u>O</u> 2/GNS	-4.626	-4.109	0.517	0.259	-4.367	4.367
<u>N</u> 2O/GNS	-3.918	-3.674	0.245	0.122	-3.796	3.796
N ₂ Q/GNS	-3.918	-3.674	0.245	0.122	-3.796	3.796
N <u>O</u> /P-GNS	-3.973	-3.701	0.272	0.136	-3.837	3.837
N <u>O</u> 2/P-GNS	-4.027	-3.755	0.272	0.136	-3.891	3.891
N ₂ O/P-GNS (Alpha)	-4.544	-2.884	1.660	0.830	-3.714	3.714
N ₂ O/P-GNS (Beta)	-4.680	-2.939	1.742	0.871	-3.810	3.810
NO/N-GNS	a -	a _	a -	а -	a _	a -
NO ₂ /N-GNS	a _	a -	a _	a -	a _	a -
<u>N</u> 2O/N-GNS (Alpha)	-3.918	-2.884	1.034	0.517	-3.401	3.401
<u>N</u> 2O/N-GNS (Beta)	-4.544	-2.966	1.578	0.789	-3.755	3.755
N <u>O</u> /PN-GNS	a _	a _	a _	a -	a -	a -
N <u>O</u> 2/PN-GNS (Alpha)	-4.653	-3.129	1.524	0.762	-3.891	3.891
N <u>O</u> 2/PN-GNS (Beta)	-4.435	-3.347	1.088	0.544	-3.891	3.891
N ₂ Q/PN-GNS	-3.918	-3.646	0.272	0.136	-3.782	3.782

ตารางที่ 4.7 ค่า E_{HOMO}, E_{LUMO}, ΔE_{sap} เคมิคัลฮาร์ดเนสท์ (η), อิเล็กโทรเคมิคัลโพเทนเชียล (μ) และมัลลิเกนอิเล็กโทรเนกาติวิตี (χ) คำนวณที่ระดับของทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ

^a non convergence

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางพลังงานของ แผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส (P) อะตอมไนโตรเจน (N) และอะตอมคู่ ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน (PN) และความสามารถในการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ได้แก่ ไนตริก ออกไซด์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O) บนแผ่นนาโน แกรฟีน (GNS) แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส (P-GNS) อะตอมไนโตรเจน (N-GNS) และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ไนโตรเจน (PN-GNS) ด้วยทฤษฏีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นที่ระดับ B3LYP/LanL2DZ ของทฤษฏี

จากการศึกษาสมบัติทางโครงสร้าง ได้แก่ ระยะห่างของการดูดซับ ความยาวพันธะ และมุมพันธะ พบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนสามารถยึดจับกับอะตอมของฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจนที่โด้ปลงไปบนแผ่นนาโนแกรฟีนได้ และโครงสร้างของแผ่นนาโนแกรฟีนบริเวณที่โด้ปด้วยอะตอม ฟอสฟอรัส และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนจะเปลี่ยนแปลงไป โดยอะตอมของธาตุที่โด้ปจะไม่อยู่ ในระนาบเดียวกับอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนของแผ่นนาโนแกรฟีน ความยาวพันธะระหว่างคาร์บอน อะตอมของแผ่นนาโนแกรฟีนโด้ปอะตอมฟอสฟอรัส และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนจะมีความยาว เพิ่มขึ้น ในขณะที่มุมพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมจะมีค่าลดลง เมื่อเทียบกับแผ่นนาโนแกรฟีนปกติ ส่วนโครงสร้างของแผ่นนาโนแกรฟีนบริเวณที่โด้ปด้วยอะตอมไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

จากผลการคำนวณความสามารถในการดูดซับโมเลกุลแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ บนแผ่นนา โนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน พบว่าแผ่นนาโนแกรฟีนสามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้ โดยมีระยะห่างของการดูดซับอยู่ ในช่วงระหว่าง 3.100 - 3.794 อังสตรอม และค่าพลังงานการดูดซับอยู่ในช่วงระหว่าง -0.21 ถึง -18.36 กิโลแคลอรี/โมล ส่วนแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ไนโตรเจน สามารถดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้เช่นเดียวกัน โดยการดูดซับจะเกิดบริเวณอะตอม ของธาตุที่โด๊ปองบนแผ่นนาโนแกรฟีน จากผลการคำนวณระยะห่างของการดูดซับอยู่ในช่วงระหว่าง 2.006 - 3.942 อังสตรอม และค่าพลังงานการดูดซับอยู่ในช่วงระหว่าง -10.74 ถึง -88.52 กิโลแคลอรี/ โมล พบว่าการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจนลงบนแผ่นนา โนแกรฟีน ทำให้ความสามารถในการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และไนตรัสออกไซด์ (N₂O) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นนาโนแกรฟีนปกติ โดยจะให้ค่าพลังงานการดูดซับที่สู่งกว่าและระยะห่างของการ ดูดซับที่สั้นกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เน่น นาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เป็นกร ดูดซับที่สั้นกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าการดูดจับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่น นาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เป็นการ ดูดซับทางกายภาพ (physisorption)

จากการศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ พลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ พลังงาน ต่ำสุดที่ไม่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ ค่าเคมิคัลฮาร์ดเนสท์ ค่าอิเล็กโทรเคมิคัลโพเทนเชียล ค่ามัลลิเกนอิเล็ก โทรเนกาติวิตี และการถ่ายโอนประจุบางส่วน พบว่าเมื่อมีการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ลงบนแผ่นนาโนแกรฟีนสมบัติต่างๆ ของแผ่นนาโนแกรฟีนจะ เปลี่ยนแปลงไป จึงกล่าวได้ว่าการโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ ในโตรเจน มีผลต่อสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของแผ่นนาโนแกรฟีน โดยมีผลทำให้สภาพการนำเปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันก็พบว่าการดูดซับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์บนแผ่นนาโนแกรฟีน แผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ป อะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ก็ส่งผลทำให้สมบัติทาง อิเล็กทรอนิกส์ของแผนนาโนแกรฟีน และแผ่นนาโนแกรฟีนที่โด๊ปเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถนำวัสดุชนิดนี้ไปเป็นตัวตรวจวัดแก๊สได้

ความสามารถในการดูดซับแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันได้แก่ สมบัติ ทางโครงสร้าง ความยาวพันธะ สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การถ่ายโอนประจุบางส่วน ซึ่งจากผล การคำนวณพบการถ่ายโอนประจุบางส่วนระหว่างแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์กับแผ่นนาโนแกรฟันโด๊ป อะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน แสดงให้เห็นว่าแผ่นนาโน แกรฟันโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน เหมาะที่จะนำมา พัฒนาเป็นวัสดุสำหรับเป็นตัวตรวจวัดหรือกักเก็บแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์เหล่านี้

จากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับพัฒนาวัสดุชนิดใหม่สำหรับตรวจวัด หรือกักเก็บแก๊สกลุ่มไนโตรเจนออกไซด์ได้ ซึ่งแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน ก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกที่ควรศึกษากันต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแผ่นนาโนแกรฟีนโด๊ปอะตอมฟอสฟอรัส อะตอมไนโตรเจน และอะตอมคู่ฟอสฟอรัส/ไนโตรเจน สามารถดูดซับแก๊สไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และไนตรัส ออกไซด์ ได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าขณะดูดซับสมบัติต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง ชัดเจน ทำให้วัสดุนาโนชนิดใหม่นี้สามารถนำไปพัฒนาเป็นวัสดุสำหรับดูดซับหรือกักเก็บแก๊สเหล่านี้ได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดหาแก๊สเหล่านี้ได้อีกเช่นกัน

บรรณานุกรม

Ao, Z.M., Yang, J., Li, S., Jiang, Q. (2008). *Chemical Physics Letters*, 461, 276-279.

Banerjee, S., Bhattacharyya, D. (2008). *Computational Materials Science*, 44, 41–45.

Basu, S., Bhattacharyya, P. (2012). *Sensors and Actuators B: Chemical*, 173, 1–21.

Becke, A.D. (1988). Physics Review A, 38, 3098-3100.

Becke, A.D. (1993). Journal of Chemical Physics, 98, 5648–5652.

Chen,Y., Wang, J., Liu, Z.-M. (2012). *Chinese Journal of Analytical Chemistry*, 4, 1772–1779.

Chen, Y., Yang, X.C., Liu, Y.J., Zhao, J.X., Cai, Q.H., Wang, X.Z. (2012). *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, 39, 126–132.

Chi, M., Zhao, Y.-P. (2009). Computational Materials Science, 46, 1085-1090.

Chu, S., Hu, L., Hu, X., Yang, M., Deng, J. (2013). *International Journal of Hydrogen Energy*, 36, 12324-12328.

Flükiger, P., Lüthi, H.P., Portmann, S. (2000). *MOLEKEL 4.3*. Manno: Swisscenter for scientific computing

Frisch MJ, Trucks GW, Schlegel HB, Scuseria GE, Robb MA, Cheeseman JR, Montgomery JA Jr, Vreven T, Kudin KN, Burant JC, Millam JM, Iyengar SS, Tomasi J, Barone V, Mennucci B, Cossi M, Scalmani G, Rega N, Petersson GA, Nakatsuji H, Hada M, Ehara M, Toyota K, Fukuda R, Hasegawa J, Ishida M, Nakajima T, Honda Y, Kitao O, Nakai H, Klene M, Li X, Knox JE, Hratchian HP, Cross JB, Adamo C, Jaramillo J, Gomperts R, Stratmann RE, Yazyev O, Austin AJ, Cammi R, Pomelli C, Ochterski JW, Ayala PY, Morokuma K, Voth GA, Salvador P, Dannenberg JJ, Zakrzewski VG, Dapprich S, Daniels AD, Strain MC, Farkas O, Malick DK, Rabuck AD, Raghavachari K, Foresman JB, Ortiz JV, Cui Q, Baboul AG, Clifford S, Cioslowski J, Stefanov BB, Liu G, Liashenko A, Piskorz P, Komaromi I, Martin RL, Fox DJ, Keith T, Al-Laham MA, Peng CY, Nanayakkara A, Challacombe M, Gill PMW, Johnson B, Chen W, Wong MW, Gonzalez C, Pople JA (2006) Gaussian 03, Revision D.02. Gaussian Inc, Wallingford

Frisch, M.J., Trucks, G.W., Schlegel, H.B., Scuseria, G.E., Robb, M.A., Cheeseman, J.R., Montgomery, J.A., Vreven, T., Kudin, K.N., Burant, J.C., Millam, J.M., Iyengar, S.S., Tomasi, J., Barone, V., Mennucci, B., Cossi, M., Scalmani, G., Rega, N., Petersson, G.A., Nakatsuji, H., Hada, M., Ehara, M., Toyota, K., Fukuda, R., Hasegawa, J., Ishida, M., Nakajima, T., Honda, Y., Kitao, O., Nakai, H., Klene, M., Li, X., Knox, J.E., Hratchian, H.P.,

Cross, J.B., Bakken, V., Adamo, C., Jaramillo, J., Gomperts, R., Stratmann, R.E., Yazyev, O., Austin, A.J., Cammi, R., Pomelli, C., Ochterski, J.W., Ayala, P.Y., Morokuma, K., Voth, G.A., Salvador, P., Dannenberg, J.J., Zakrzewski, V.G., Dapprich, S., Daniels, A.D., Strain, M.C., Farkas, O., Malick, D.K. Rabuck, A.D., Raghavachari, K., Foresman, J.B., Ortiz, J.V., Cui, Q., Baboul, A.G., Clifford, S., Cioslowski, J., Stefanov, B.B., Liu, G., Liashenko, A., Piskorz, P., Komaromi, I., Martin, R.L., Fox, D.J., Keith, T., Al–Laham, M.A., Peng, C.Y., Nanayakkara, A., Challacombe, M., Gill, P.M.W., Johnson, B., Chen, W., Wong, M.W., Gonzalez, C., Pople, J.A. (2008). *GAUSSIAN 09*, Revision A.02. Gaussian Inc: Wallingford CT.

Hamadanian, M., Fotooh, F.K. (2014). *Computational Materials Science*, 82, 497–502.

Hay, P.J., Wadt, W.R. (1985). Journal of Chemical Physics, 82, 270–283.

Hay, P.J., Wadt, W.R. (1985). Journal of Chemical Physics, 82, 299–310.

Kang, H.S. (2005). Journal of the American Chemical Society, 127, 9839-9843.

Lee, C., Yang, W., Parr, R.G. (1988). Physics Review B, 37, 785–789.

Leszczynski, J. (2001). *Computational chemistry: Reviews of Current trends*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Lewars, E. (2003). *Computational chemistry: Introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics*. Dordrecht: Kluwer academic Publishers.

Lv, R., Terrones, M. (2012). *Materials Letters*, 78, 209-218.

Ma, F., Zhang, Z., Jia, H., Liu, X., Hao, Y., Xu, B. (2010). *Journal of Molecular Structure: Theochem*, 955, 134-139.

Mao, H.Y., Lu, Y.H., Lin, J.D., Zhong, S., Wee, A.T.S., Chen, W. (2013). *Progress in Surface Science*, 88, 132-159.

Novoselov, K.S., Geim, A.K., Morozov, S.V., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S.V. *et al.* (2004). *Science*, 306, 666–669.

Rad, A.S., Foukolaei, V.P. (2015). Synthetic Metals, 210, 171–178.

Rad, A.S., Shabestari, S.S., Mohseni, S., Aghouzi, S.A. (2016). *Journal of Solid State Chemistry*, 237, 204–210.

Wanno, B., Tabtimsai, C. (2014). *Superlattices and Microstructures*, 67, 110–117.

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ภาคผนวก

แสดงภาพการใช้โปรแกรมประกอบการวิจัย

ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Gaussview



ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Gaussian ที่ติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Linux ในการคำนวณ





ภาพตัวอย่างการใช้โปรแกรม Molekel ในการนำเสนอภาพโครงสร้างต่างๆ ที่ได้จากการ คำนวณ

ประวัติผู้วิจัย

- 1. ชื่อ-นามสกุล ดร. วันดี รักไร่
- 2. ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่อยู่ 80 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม โทรศัพท์มือถือ 081-7165946 E-mail wandee.rakrai@gmail.com
- 4. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	ปีที่จบ	สาขา	สถาบัน	ประเทศที่จบ
ปริญญาเอก	2555	สาขาวิชาเคมี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไทย
ปริญญาโท	2546	สาขาวิชาเคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไทย
ปริญญาตรี	2543	สาขาวิชาเคมี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ไทย

5. ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

<u>บทความวิชาการ</u>:

 วันดี รักไร่. 2555. ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์บนพื้นผิวของท่อนาโนคาร์บอนแบบ ผนังเดี่ยวด้วยวิธีการสะสมไอสารเคมี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555).

Publication:

- 1. Tabtimsai C, **Rakrai W**, Wanno B. Hydrogen adsorption on graphene sheets doped with group 8B transition metal: A DFT investigation. Vacuum, 2017, 139, 101-108.
- 2. Buasang P, **Rakrai W**, Wanno B, Tabtimsai C. DFT investigation of NH₃, PH₃, and AsH₃ adsorptions on Sc-, Ti-, V-, and Cr-doped single-walled carbon nanotubes. Applied Surface Science, 2017, 400, 506–514.
- Buasang P, Rakrai W, Wanno B, Tabtimsai C. Geometric, energetic and electronic properties of 4d transition metals doped (5,5) single-walled carbon nanotube. The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being. (ICSSS 2016), proceeding, 2016
- 4. Tabtimsai C.; Tontapha S.; **Rakrai W**.; Wanno B. A DFT study on structural stability and electronic property of VIIIB transition metal-doped carbon nanocaps. Solid State Science, 2014, 37, 6-12.
- 5. **Rakrai W**.; Chaiprommar K.; Tanlert C.; Wanno B. A DFT Investigation on structures of bis-thiourea derivative functionalized graphene nanosheet and its

complexes with anions. The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014), *proceeding*, 2014, 435-440.

- Rakrai W.; Morakot N.; Keawwangchai S.; Kaewtong C.; Wanno B.; Ruangpornvisuti V. A theoretical investigation on structures of tripodal thiourea derivatives and their anion recognition. Structural Chemistry. 2011, 22, 839-847.
- Malumgone C.; Keawwangchai S.; Kaewtong C.; Morakot N.; Rakrai W.; Wanno B. Fluoride recognition of amide- and pyrrole-based receptors: A Theoretical study. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 2011, 2(2), 227-238.
- Chasvised S.; Rakrai W.; Morakot N.; Wanno B. DFT studies of amide reduction by borane and alane: structural stability and reaction mechanisms. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 2011, 2(1), 73-82.
- 9. Morakot N.; **Rakrai W**.; Keawwangchai S.; Kaewtong C.; Wanno B. Design and synthesis of thiourea based receptor containing naphthalene as oxalate selective sensor. Journal of Molecular Modeling. 2010, 16, 129–136.
- Wanno B.; Rakrai W.; Keawwangchai S.; Morakot N.; Morakot N.; Nunthaboot N.; Ruangpornvisuti V. A density functional investigation of 1,3-bis(4nitrophenyl)urea as anion receptor. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM. 2009, 902(1-3), 33-40.

Conferences:

- Rakrai W, Pollaboon W, Unnachart P, Wanno B., "Adsorption of halide ions on pristine, B- and Al-doped graphene nanosheets: A DFT investigation" The 41th Congress on Science and Technology of Thailand, (STT 41), Suranaree University of Technology, Thailand, November 6-8, 2015.
- Rakrai W.; Ruangpornvisuti V.; Wanno B.; "Adsorption of small alkenes on pristine and Os-doped graphene nanosheets: A DFT study" The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, (STT 40), Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, December 2-4, 2014.
- 3. Tabtimsai C., **Rakrai W**., Wanno B. Carbon monoxide adsorption on pristine, Fe-, Ru- and Os-doped single-walled carbon nanotube: A DFT study.

International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemistry Sciences, Hong Kong, October 2-4, 2014

- Tabtimsai C.; Rakrai W. and Wanno B.; "Functionalization of Aliphatic Fluorocarbon Compounds on Boron Nitride Nanotubes" The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, (STT 38), The Empress Convention Hall, Chiangmai, Thailand, October 17-19, 2012.
- 5. **Rakrai W**.; Morakot N.; Wanno B. "A Theoretical study of anion recognition based on bis-thiourea derivative receptor", International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, May 4-7, 2011.
- Rakrai W.; Morakot N.; Wanno B. "Anion recognition of tripodal thiourea derivative: A Theoretical study" The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), Tide Resort (Bangsaen Beach), Chonburi, Thailand, October 15-17, 2009.
- Rakrai W.; Keawwangchai S.; Kaewtong C.; Morakot N.; Morakot N.; Wanno B. "A Theoretical study of tripodal thiourea derivative complexation with anions" The 5th of Mahasarakham University Research Conference, Taksila Hotel, Mahasarakham, Thailand, September 10-11, 2009.
- Rakrai W.; Keawwangchai S.; Kaewtong C.; Morakot N.; Morakot N.; Wanno B. "A Theoretical study of thiourea derivative and complexation with anions" The 4th of Mahasarakham University Research Conference, Taksila Hotel, Mahasarakham, Thailand, September 4-5, 2008.
- Rakrai W.; Keawwangchai S.; Nunthaboot N.; Morakot N.; Morakot N.; Wanno B. "A Theoretical study of thiourea derivative and complexation with anions", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33), Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, October 18-20, 2007.